

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年11 月4 日 (04.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/095612 A1

(51) 国際特許分類*:H01M 4/02, 4/38, 4/04, 10/40, 4/64(21) 国際出願番号:PCT/JP2003/016186(22) 国際出願日:2003 年12 月17日(17.12.2003)(25) 国際出願の言語:日本語(26) 国際公開の言語:日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-117833 2003 年4 月23 日 (23.04.2003) 特願2003-278615 2003年7月23日(23.07.2003) лР ЛР 特願2003-282294 2003年7月30日(30.07.2003) 特願2003-290726 2003 年8 月8 日 (08.08.2003) JР 特願2003-327893 2003年9月19日(19.09.2003) JP 特願 2003-360938

2003 年10 月21 日 (21.10.2003) IP 特願2003-403528 2003 年12 月2 日 (02.12.2003) IP

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について*)*: 三井金属 鉱業株式会社 *(MITSUI MINING & SMELTING CO.,* LTD.) [JP/JP]; 〒141-8584 東京都 品川区 大崎 1 丁目 1 1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安田 清隆 (YA-SUDA, Kiyotaka) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県 上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内Saitama (JP). 坂口 善樹 (SAKAGUCHI, Yoshiki) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県 上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内Saitama (JP). 武者 信一(MUSHA, Shinichi) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県 上尾市

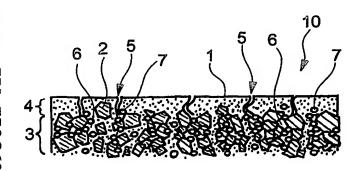
原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP). 土橋誠 (DOBASHI, Makoto) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP). 茂出木 晚宏(MODEKI, Akihiro) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP). 松島智善(MATSUSHIMA, Tomoyoshi) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP). 本田仁彦 (HONDA, Hitohiko) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP). 田口 丈雄 (TAGUCHI, Takeo) [JP/JP]; 〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社総合研究所内 Saitama (JP).

- (74) 代理人: 羽鳥修 (HATORI,Osamu); 〒107-0052 東京都 港区 赤坂一丁目 8 番 6 号 赤坂 H K N ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 *(*広域*)*: ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ

/続葉有/

(54) Title: NEGATIVE ELECTRODE FOR NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY, METHOD FOR MAN-UFACTURING SAME AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY

(54) 発明の名称: 非水電解液二次電池用負極及びその製造方法並びに非水電解液二次電池



(57) Abstract: A negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary batteries is disclosed. The negative electrode comprises a pair of collecting surface layers whose surfaces are in contact with an electrolytic solution and at least one active material layer intervening between the surface layers and containing active material particles which have a high lithium compound forming power. It is preferable that the material constituting the surfaces permeates throughout the active material layer in the thickness direction so that the surfaces are electrically connected with each other, whereby the electrode has a current collecting function as a whole. The thickness of the

surface layers is preferably 0.3-10 μ m.

(57) 要約: 非水電解液二次電池用負極を開示する。負極は、表面が電解液と接する一対の集電用表面層と、該表面層間に介在されたリチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子を含む少なくとも一層の活物質層とを備えている。前記面を構成する材料が前記活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して両面が電気的に導通しており、電極全体が一体として集電機能を有していることが好ましい。前記表面層はその厚みが好ましくは0.3~10μmである。

BEST AVAILABLE COPY

2004/095612 A1



TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, のガイダンスノート」を参照。 GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 2文字コード及び他の略語については、定期発行される FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

添付公開書類:

— 国際調査報告書

明 細 書

非水電解液二次電池用負極及びその製造方法並びに非水電解液二次電池

技術分野

本発明はリチウムイオン二次電池などの非水電解液二次電池用負極に 関する。更に詳しくは充放電の初期段階から充放電容量が高く、また集 電性が高く、更にリチウムイオンの吸脱蔵に起因する活物質の脱落が防 止されサイクル寿命が向上し、その上エネルギー密度の高い非水電解液 二次電池を得ることができる負極に関する。また本発明は、該負極の製 造方法及び該負極を用いた非水電解液二次電池に関する。

10 背景技術

15

20

25

リチウムイオン二次電池は、そのエネルギー密度が他の二次電池と比較して格段に高いことから、携帯電話やノートパソコンなどの電源として使用されている。近年、携帯用電気・電子機器の高性能化が急速に加速し、それらの消費電力も著しい増加傾向にある。そのような要求を満たすためには、電源用二次電池のさらなる高容量化が必須である。現状のリチウムイオン二次電池では、正極にリチウム含有酸化物が使用され、負極にリチウムイオンを結晶構造の層間内に貯蔵することのできる炭素系材料(グラファイト)が使用されている。現在の実用リチウム二次電池は、これらの材料の有する理論容量値に達しつつあり、高容量の新規電極材料の創出が期待されている。

そこで、グラファイトの5~10倍の容量ポテンシャルを有している Sn系合金やSi系合金の開発が活発になされている。例えば、銅箔な どの導電性金属箔を集電体とし、ケイ素やケイ素合金を含む活物質粒子 と、銅や銅合金などの導電性金属粉末との混合物を、集電体の表面上で 非酸化性雰囲気下に焼結して得られるリチウム二次電池用負極が提案さ

20

れている(特開2002-260637号公報参照)。また、銅箔など の導電性金属箔を集電体とし、その上に電解めっき法でスズ薄膜からな る活物質層を形成し、その上に電解めっき法で銅の薄層を形成したリチ ウム二次電池用負極も提案されている(特開2002-289178号 公報参照)。

しかし特開2002-260637号公報記載の負極においては、活 物質粒子が電解液にさらされていることから、リチウムイオンの吸脱蔵 に起因する活物質の粒子の膨張収縮に起因して該活物質粒子の脱落が起 こりやすく、電池のサイクル寿命が低下しやすい。またこの負極におけ る集電体は、10~100μmといった比較的厚いものなので、負極全 体に占める活物質の割合が低くそれに起因してエネルギー密度を高める ことが容易でない。特開2002-289178号公報記載の負極にお いては、スズ薄膜の活物質層を覆う銅の薄層はその厚みが0.01~0. 2μmと極薄のものであり島状に分布しているので、活物質層の大部分 が電解液にさらされている。従って、特許文献1記載の負極と同様に、 15 リチウムイオンの吸脱蔵に起因する活物質の脱落が起こりやすい。

この他に、リチウムと合金を作らない金属元素からなる集電部の一面 に、リチウムと合金を作る金属元素を含有する層を形成し、この層の上 に、リチウムと合金を作らない金属元素の層を形成してなる負極が提案 されている(特開平8-50922号公報参照)。この公報によれば、 電池の充放電に起因して、リチウムと合金を作る金属元素を含有する層 が微粉化することを、この構成の負極によって抑えることができるとさ れている。しかし前記文献の実施例の記載によれば、最表面に形成され ているリチウムと合金を作らない金属元素の層はその厚みが50nmと 極めて薄いので、該層が、リチウムと合金を作る金属元素を含有する層 の表面を十分に被覆していない可能性がある。その場合、リチウムと合 金を作る金属元素を含有する層が電池の充放電に起因して微粉化する

と、その脱落を十分に抑えることができない。逆にリチウムと合金を作 らない金属元素の層が、リチウムと合金を作る金属元素を含有する層の 表面を完全に被覆している場合、該層が、リチウムと合金を作る金属元 素を含有する層へ電解液が流通することを妨げてしまい十分な電極反応 が起こりづらくなってしまう。このような相反する機能を両立させる技 術は未だ提案されていない。

これとは別に、リチウムイオン二次電池用の集電体として、表面に適 度の凹凸を形成したものや、厚さ方向に貫通する微細孔を形成したもの が知られている。例えば、厚み方向に貫通する連通孔が三次元網目構造 10 をなして形成されている多孔質電解金属箔からなる集電体が提案されて いる(特開平8-236120号公報参照)。この金属箔は、ドラムカ ソード体の表面に金属を電析してその金属箔層を形成し、それをドラム カソード体から剥離して電解金属箔にする際に、剥離後に露出したドラ ムカソード体の表面に、少なくとも厚みが14nmである酸化皮膜を形 成し、その上に電解金属箔形成することで製造される。しかしこの金属 15 箔の開孔率や開孔径は、ドラムカソード体に形成する酸化皮膜の厚さに 依存し、しかもこの酸化皮膜は常に箔とともに少しずつ剥がれていくの で、開孔率や開孔径の制御が困難である。また、開孔径が比較的小さい 上に三次元網目構造を有しているので、箔の表裏にそれぞれ塗布される 活物質ペーストどうしが直接接触することが難しい。従ってペーストと 20 箔との密着性を向上させるには限界があると考えられる。

前記の金属箔の有する問題点を解決すべく、本出願人は先に、平面方向平均粒径1~50μmの銅粒子を互いに平面的に接合するように電析によって形成した多孔質銅箔であって、光透過率が0.01%以上であると共に、箔を形成する際に陰極面側であった表面の表面粗度とその反対側の表面の表面粗度との差がRzで5~20μmの範囲にある多孔質銅箔を提案した(国際公開第00/15875号パンフレット参照)。

この銅箔をリチウムイオン二次電池の集電体として用いると、(イ)電解液が流通しやすくなり、限られた量の電解液を均一に活物質へ浸透させることができる、(ロ)充放電中におけるLiイオンや電子の授受を妨げにくくなる、(ハ)表面に適度の凹凸を有しているので、活物質との密着性に優れている、という有利な効果が奏される。しかしこの多孔質銅箔の製造方法では、ドラム状カソード体に銅を電析した後、該カソード体から剥離された状態の該銅箔に各種の加工が施されることから、銅箔の状態が不安定になり、ハンドリング性が良好とは言えず、大量生産が容易ではない。また、この多孔質銅箔を集電体として用い、その各10 面に負極合剤を塗布してなる非水電解液二次電池用負極においては、リチウムの吸脱蔵に起因して負極活物質が脱落しやすくなり、サイクル特性が低下しやすいという問題がある。

発明の開示

20

従って本発明は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消し得る 15 非水電解液二次電池用負極及びその製造方法並びに非水電解液二次電池 を提供することを目的とする。

本発明者らは鋭意検討した結果、活物質の層を、集電体としても機能する2つの表面層で挟むことによって、リチウムの吸脱蔵に起因する活物質の脱落が防止されると共に集電機能を維持しつつ電極全体に占める活物質の占める割合が高められることを知見した。

本発明は、表面が電解液と接する一対の集電用表面層と、該表面層間に介在されたリチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子を含む少なくとも一層の活物質層とを備えていることを特徴とする非水電解液二次電池用負極を提供することにより前記目的を達成したものである。本発明の負極には、後述する図1に示す実施形態のものと、図8に示す実施形態のものとが包含される。図1に示す実施形態の負極は、心材としての

導電性金属箔層を具備しないものであり、図8に示す実施形態の負極 は、心材としての導電性金属箔層を具備するものである。

また本発明は、前記負極の好ましい製造方法として、

キャリア箔上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質 5 層を形成し、

該活物質層が形成された該キャリア箔を、金属材料を含むめっき浴中 に浸漬して電解めっきを行い、該活物質層を含む電極を形成し、

然る後、該電極を該キャリア箔から剥離分離することを特徴とする非 水電解液二次電池用負極の製造方法を提供するものである。

10 また本発明は前記負極の好ましい製造方法の別法として、

表面に多数の陽イオン交換基を有するキャリア樹脂を金属イオン含有 液で処理して該陽イオン交換基の金属塩を生成させ、該金属塩を還元し てキャリア樹脂の前記表面に触媒核となる前記金属の被膜を形成し、該 被膜上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方 の集電用表面層を形成し、該集電用表面層の上に活物質の粒子を含む導 電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、該活物質層の上にリチウム 化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の集電用表面層を 形成し、然る後、前記キャリア樹脂を剥離又は溶解により前記一方の集 電用表面層から分離することを特徴とする非水電解液二次電池用負極の 製造方法を提供するものである。

更に本発明は、前記負極を備えることを特徴とする非水電解液二次電池を提供するものである。

図面の簡単な説明

15

20

図1は、本発明の負極の第1の実施形態の要部を拡大して示す模式図 25 である。 図2は、本発明の負極の一実施形態の表面を示す電子顕微鏡写真像である。

図3は、本発明の負極の他の実施形態の表面を示す電子顕微鏡写真像である。

5 図4 (a) ~図4 (d) は、図1に示す負極の製造方法の一例を示す 工程図である。

図5 (a) 及び図5 (b) はそれぞれ、図4 (a) ~図4 (d) に示す方法で製造された負極の断面構造を示す電子顕微鏡写真像である。

図6 (a) ~図6 (f) は、本発明の負極の製造方法の別の例を示す 10 工程図である。

図7 (a) ~図7 (e) は、集電用表面層の形成方法の別の例を示す 工程図である。

図8は、本発明の負極の第2の実施形態の要部を拡大して示す模式図である。

15 図9は、実施例2-1で得られた負極の断面の電子顕微鏡写真像である。

図10(a)及び図10(b)はそれぞれ、実施例3-1で得られた 集電用表面層の走査型電子顕微鏡写真像及び光を透過させた状態での写 真像である。

20 図11(a)及び図11(b)はそれぞれ、実施例3-1で得られた 負極について測定された、キャリア箔から剥離した表面層側の充電特性 及び被覆めっき側の充電特性を示すグラフである。

図12は、実施例2-1並びに比較例2-1及び2-2で得られた電極についての充放電サイクル数と放電容量との関係を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

25

以下、本発明の非水電解液二次電池用負極をその好ましい実施形態に

基づき説明する。図1には、本発明の負極の第1の実施形態の要部を拡大した模式図が示されている。なお図1においては、負極の一方の面側のみが示されており他方の面側は示されていないが、他方の面側の構造もほぼ同様となっている。

5 本実施形態の負極10は、非水電解液と接する表裏一対の面である第1の面1及び第2の面(図示せず)を有している。負極10は、両面間にリチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子2を含む活物質層3を備えている。活物質層3は、該層3の各面にそれぞれ形成された一対の集電用表面層(一方の集電用表面層は図示せず)4によって連続的に被覆されている。各表面層4は、第1の面1及び第2の面をそれぞれ含んでいる。また図1から明らかなように負極10は、従来の負極、例えば先に述べた特許文献1及び2に記載の負極に用いられてきた集電体と呼ばれる集電用の厚膜導電体(例えば金属箔)を有していない。

集電用表面層4は、本実施形態の負極2における集電機能を担ってい 15 る。また表面層 4 は、活物質層 3 に含まれる活物質がリチウムイオンを 吸脱蔵することによる該活物質の膨張収縮に起因して脱落することを防 止するためにも用いられている。表面層3は、非水電解液二次電池の集 電体となり得る金属から構成されている。特にリチウム二次電池の集電 体となり得る金属から構成されていることが好ましい。そのような金属 としては例えば、リチウム化合物の形成能の低い金属材料が挙げられ 20 る。具体的には銅、ニッケル、鉄、コバルト又はこれらの金属の合金な どが挙げられる。これらの金属のうち銅及びニッケル或いはそれらの合 金を用いることが特に好適である。電極10の強度を高める観点からは ニッケルを用いることが好ましい。また負極10のフレキシビリティを 高める観点からは銅を用いることが好ましい。2つの表面層は、その構 25 成材料が同じであってもよく、或いは異なっていてもよい。「リチウム 化合物の形成能が低い」とは、リチウムと金属間化合物若しくは固溶体 を形成しないか、又は形成したとしてもリチウムが微量であるか若しく は非常に不安定であることを意味する。

各表面層 4 は、従来の電極に用いられている集電用の厚膜導電体よりもその厚みが薄いものである。具体的には 0 . 3 ~ 1 0 μ m 程度、特に 1 ~ 5 μ m 程度の薄層であることが好ましい。これによって、必要最小限の厚みで活物質層 3 をほぼ万遍なく連続的に被覆することができる。その結果、活物質の粒子 2 の脱落を防止することができる。またこの程度の薄層とすること、及び集電用の厚膜導電体を有していないことで、負極全体に占める活物質の割合が相対的に高くなり、単位体積当たり及び単位重量当たりのエネルギー密度を高めることができる。従来の負極では、負極全体に占める集電用の厚膜導電体の割合が高かったので、エネルギー密度を高めることに限界があった。前記範囲の薄い表面層 4 は、後述するように電解めっきによって形成されることが好ましい。なお 2 つの表面層 4 はその厚みが同じでもよく、或いは異なっていてもよ

先に述べた通り、2つの表面層 4 は第の面 1 及び第 2 の面をそれぞれ 含んでいる。これらの面は本実施形態の電極における最外面をなしている。本実施形態の負極 1 0 が電池に組み込まれた場合、第 1 の面及び第 2 の面は電解液と接する面となり電極反応に関与する。これとは対照的 1 に、従来の負極における集電用の厚膜導電体は、その両面に活物質層が 形成されている場合には電解液と接することはなく電極反応に関与せず、また片面に活物質層が形成されている場合であっても一方の面しか 電解液と接しない。つまり本実施形態の負極 1 0 には、従来の負極で用いられていた集電用の厚膜導電体が存在せず、負極の最外面に位置する 25 層、即ち表面層 4 が電極反応に関与すると共に集電機能と活物質の脱落を防止する機能とを兼ねている。

第1の面1及び第2の面をそれぞれ含む各表面層4は何れも集電機能を有しているので、本実施形態の負極10を電池に組み込んだ場合には、何れの表面層4にも電流取り出し用のリード線を接続することができるという利点がある。

5 図1に示すように負極10は、第1の面1及び第2の面において開孔し且つ活物質層3と通ずる多数の微細空隙5を有している。微細空隙5 は各集電用表面層4の厚さ方向へ延びるように該表面層4中に存在している。微細空隙5が形成されていることで、非水電解液が活物質層3へ十分に浸透することができ、活物質の粒子2との反応が十分に起こる。10 微細空隙5は、表面層4を断面観察した場合にその幅が約0・1μmから約10μm程度の微細なものである。微細であるものの、微細空隙5は非水電解液の浸透が可能な程度の幅を有している。尤も非水電解液は水系の電解液に比べて表面張力が小さいことから、微細空隙5の幅が小さくても十分に浸透が可能である。微細空隙5は、後述する種々の方法で形成することが可能である。好ましくは表面層4を電気めっきで形成する際に同時に形成される。

第1の面1及び第2の面を電子顕微鏡観察により平面視したとき、少なくとも一方の面における微細空隙5の平均開孔面積は、好ましくは $0.1\sim100\,\mu\,\mathrm{m}^2$ であり、更に好ましくは $0.1\sim50\,\mu\,\mathrm{m}^2$ であり、一層好ましくは $0.1\sim20\,\mu\,\mathrm{m}^2$ であり、更に一層好ましくは $0.5\sim10\,\mu\,\mathrm{m}^2$ 程度である。この範囲の開孔面積とすることで、非水電解液の十分な浸透を確保しつつ、活物質の粒子2の脱落を効果的に防止することができる。また充放電の初期段階から充放電容量を高めることができる。活物質の粒子2の脱落を一層効果的に防止する観点から、前記の平均開孔面積は、活物質の粒子2の最大断面積の $0.1\sim50\%$ 、特に $0.1\sim20\%$ であることが好ましい。活物質の粒子2の最大断面積とは、活物質の粒子2の粒径 (D_{50} 値)を測定し、該粒子2を、 D_{50} 値

の直径を有する球とみなしたときの最大断面積をいう。

第1の面1及び第2の面のうち、平均開孔面積が前記の範囲を満たす 面を電子顕微鏡観察により平面視したときに、観察視野の面積に対する 微細空隙 5 の開孔面積の総和の割合(この割合を開孔率という)は、0. 1~20%であり、好ましくは0.5~10%である。この理由は微細 空隙5の開孔面積を前記の範囲内とすることと同様の理由である。更に 同様の理由により、第1の面1及び第2の面のうち、平均開孔面積が前 記の範囲を満たす面を電子顕微鏡観察により平面視したときに、どのよ うな観察視野をとっても、100μm×100μmの正方形の視野範囲 内に1個~2万個、特に10個~1千個、とりわけ50個~500個の 10 微細空隙5が存在していることが好ましい(この値を分布率という)。 図2には、本発明の負極の一例の表面を電子顕微鏡観察して撮影した写 真が示されている。図2において、黒い小斑点が微細空隙5の開孔であ る。なお図2は、後述する実施例1に従い製造された負極を観察対象と して撮影されたものである。また図3には、本発明の負極の他の例の表 15 面を電子顕微鏡観察して撮影した写真が示されている。

図2及び図3に示す通り電子顕微鏡観察によって微細空隙5の有無は確認できるが、微細空隙5はその幅が極めて小さいことから、場合によっては電子顕微鏡観察でも明確にその存在の有無が判定できないことがある。そのような場合に微細空隙5の有無を判定する方法として、本発明では次の方法を採用している。微細空隙5の有無の判定対象となる負極を用いて電池を構成し充放電を一回行う。その後に負極断面を電子顕微鏡観察して、充放電前と断面構造が変化している場合には、充放電前の負極には微細空隙5が形成されていると判断する。充放電前と断面構造が変化している原因は、充放電前の負極に存在している微細空隙5を通じて非水電解液が活物質層3に到達し、非水電解液中のリチウムイオンと活物質の粒子2との反応が起こった結果によるものだからである。

25

第1の面1及び第2の面間に位置する活物質層3は、リチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子2を含んでいる。該活物質としては、例えばシリコン系材料やスズ系材料、アルミニウム系材料、ゲルマニウム系材料が挙げられる。活物質層3は2つの表面層4によって被覆されているので、活物質がリチウムイオンを吸脱蔵することに起因して脱落することが効果的に防止される。活物質の粒子2は微細空隙5を通じて電解液と接することができるので、電極反応が妨げられることもない。

負極全体に対する活物質の量が少なすぎると電池のエネルギー密度を十分に向上させにくく、逆に多すぎると活物質の脱落が起こりやすくなる傾向にある。これらを勘案すると、活物質の量は負極全体に対して好ましくは5~80重量%であり、更に好ましくは10~50重量%、一層好ましくは20~50重量%である。

活物質層 3 の厚みは、負極全体に対する活物質の量の割合や活物質の粒径に応じて適宜調節することができ、本実施形態においては特に臨界的なものではない。一般には $1\sim1$ 0 0 μ m、特に $3\sim4$ 0 μ m程度である。活物質層 3 は、後述するように、活物質の粒子 2 を含む導電性スラリーを塗布することによって形成されることが好ましい。

表面層 4 及び活物質層 3 を含む負極全体の厚みは、負極の強度やエネルギー密度を高めること考慮すると、 $2\sim5$ $0~\mu$ m、特に 1 $0\sim5$ $0~\mu$ m程度であることが好ましい。

活物質層3においては、第1の面1及び第2の面をそれぞれ含む各表 面層4を構成する材料が活物質層3の厚み方向全域に亘って浸透してい ることが好ましい。そして浸透した該材料中に活物質の粒子2が存在し ていることが好ましい。つまり活物質の粒子2は負極10の表面に実質 的に露出しておらず表面層4の内部に包埋されていることが好ましい。 これによって、活物質層3と表面層4との密着性が強固なものとなり、 活物質の脱落が一層防止される。また活物質層3中に浸透した前記材料 10 を通じて表面層4と活物質との間に電子伝導性が確保されるので、電気 的に孤立した活物質が生成すること、特に活物質層3の深部に電気的に 孤立した活物質が生成することが効果的に防止され、集電機能が保たれ る。その結果、負極としての機能低下が抑えられる。更に負極の長寿命 15 化も図られる。このことは、活物質として半導体であり電子伝導性の乏 しい材料、例えばシリコン系材料を用いる場合に特に有利である。この ことから明らかなように、本実施形態の負極は、金属発泡体中に活物質 粒子を坦持させて、該発泡体の両面に電解めっきを施してなる従来の電 極とはその構造が全く相違するものである。かかる金属発泡体を用いた 従来の電極では、活物質の粒子を金属発泡体の骨格構造に十分に密接さ 20 せることが容易ではないので、電子伝導性を高めにくく、活物質の性能 を十分に活用することが容易ではない。

集電用表面層 4 を構成する材料は、活物質層 3 をその厚み方向に貫いており、両表面層 4 とつながっていることが好ましい。それによって 2 つの表面層 4 は前記材料を通じて電気的に導通することになり、負極全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施形態の負極 1 0 は、負極全体が一体として集電機能を有する。集電用表面層 4 を構成す

る材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して両表面層同士がつながっていることは、該材料を測定対象とした電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。集電用表面層 4 を構成する材料を、活物質層中に浸透させるための好ましい方法は後述する。

- 活物質層3における活物質の粒子2の間は、表面層4の構成材料で完 5 全に満たされているのではなく、該粒子間に空隙6が存在していること が好ましい(この空隙は、集電用表面層4に形成された微細空隙5とは 異なるものであることに留意すべきである)。この空隙6の存在によっ て、活物質の粒子2がリチウムを吸脱蔵して膨張収縮することに起因す 10 る応力が緩和される。この観点から、活物質層3における空隙6の割合 は5~30体積%程度、特に5~9体積%程度であることが好ましい。 空隙6の割合は、電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。 後述するように活物質層3は活物質の粒子2を含む導電性スラリーを塗 布し乾燥させることによって形成されることから、活物質層3には自ず と空隙6が形成される。従って空隙6の割合を前記範囲にするために 15 は、例えば活物質の粒子2の粒径、導電性スラリーの組成、スラリーの 塗布条件を適切に選択すればよい。またスラリーを塗布乾燥して活物質 層3を形成した後、適切な条件下でプレス加工して空隙6の割合を調整 してもよい。
- 20 活物質層 3 中には活物質の粒子 2 に加えて導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子 7 が含まれていることが好ましい。これによって負極 1 0 に電子伝導性が一層付与される。この観点から活物質層 3 中に含まれる導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子 7 の量は 0 . 1 ~ 2 0 重量%、特に 1 ~ 1 0 重量%であることが好ましい。導電性炭素材料としては例えばアセチレンブラックやグラファイトなどの粒子が用いられる。これらの粒子の粒径は 4 0 μm以下、特に 2 0 μm以下であることが、電子伝導性の一層付与の点から好ましい。該粒子の粒径の下限値に

特に制限はなく小さいほど好ましい。該粒子の製造方法に鑑みると、その下限値は 0.01 μ m 程度となる。

次に活物質の詳細について説明する。活物質として先に述べたシリコン系材料やスズ系材料が用いられる場合、該シリコン系材料又はスズ系 材料の粒子としては、例えばイ)シリコン単体又はスズ単体の粒子、ロ)少なくともシリコン又はスズと炭素との混合粒子、ハ)シリコン又はスズと炭素との混合粒子、ハ)シリコン又はスズと金属との化合物粒子、ホ)シリコン又はスズと金属との化合物粒子と、金属の粒子との混合粒子、ヘ)シリコン単体又はスズ単体の粒子の表面に金属が被覆されてな る粒子などが挙げられる。ロ)、ハ)、ニ)、ホ)及びへ)の粒子を用いると、イ)のシリコン単体又はスズ単体の粒子を用いる場合に比べて、リチウムの吸脱蔵に起因するシリコン系材料の微粉化が一層抑制されるという利点がある。また半導体であり電子伝導性の乏しいシリコンに電子伝導性を付与できるという利点がある。

特に、シリコン系粒子又はスズ系粒子がロ)の少なくともシリコン又 15 はスズと炭素との混合粒子からなる場合には、サイクル寿命が向上する と共に負極容量が増加する。この理由は次の通りである。炭素、特に非 水電解液二次電池用負極に用いられているグラファイトは、リチウムの 吸脱蔵に寄与し、300mAh/g程度の負極容量を有し、しかもリチ ウム吸蔵時の体積膨張が非常に小さいという特徴を持つ。一方、シリコ 20 ンは、グラファイトの10倍以上である4200mAh/g程度の負極 容量を有するという特徴を持つ。反面シリコンは、リチウム吸蔵時の体 積膨張がグラファイトの約4倍に達する。そこで、シリコン又はスズと グラファイトのような炭素とを所定の比率でメカニカルミリング法など を用い混合・粉砕して、粒径が約 0.1~1μmの均質に混合された粉 25 末とすると、リチウム吸蔵時のシリコン又はスズの体積膨張がグラファ イトによって緩和されて、サイクル寿命が向上し、また1000~30

00mAh/g程度の負極容量が得られる。シリコン又はスズと炭素との混合比率は、シリコン又はスズの量が10~90重量%、特に30~70重量%、とりわけ30~50重量%であることが好ましい。一方、炭素の量は90~10重量%、特に70~30重量%、とりわけ70~50重量%であることが好ましい。組成がこの範囲内であれば、電池の高容量化及び負極の長寿命化を図ることができる。なお、この混合粒子においては、シリコンカーバイドなどの化合物は形成されていない。

シリコン系粒子又はスズ系粒子がロ)の粒子からなる場合、該粒子は、シリコン又はスズ及び炭素に加えて他の金属元素を含む、3種以上の元 素の混合粒子であってもよい。金属元素としてはCu、Ag、Li、Ni、Co、Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn、In、V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される1種類以上の元素が挙げられる(以下これらの元素を総称して添加金属という)。

シリコン系粒子又はスズ系粒子が、ハ)のシリコン又はスズと金属と 15 の混合粒子である場合、該混合粒子に含まれる金属としては、前述した 添加金属の1種又は2種以上が挙げられる。これらの添加金属のうち、 Cu、Ag、Ni、Co、Ceが好ましく、特に電子伝導性に優れ且つ リチウム化合物の形成能の低さの点から、Cu、Ag、Niを用いるこ とが望ましい。また添加金属としてLiを用いると、活物質中に予め金 20 属リチウムが含まれることになり、不可逆容量の低減、充放電効率の向 上、及び体積変化率の低減によるサイクル寿命向上等の利点が生ずるの で好ましい。ハ)のシリコン又はスズと金属との混合粒子においては、 シリコン又はスズの量が30~99.9重量%、特に50~95重量%、 とりわけ85~95重量%であることが好ましい。一方、添加金属の量 25 は 0. 1~70 重量%、特に 5~50 重量%、とりわけ 5~15 重量% であることが好ましい。組成がこの範囲内であれば、電池の高容量化及

び負極の長寿命化を図ることができる。

ハ)のシリコン又はスズと金属との混合粒子は例えば次に述べる方法で製造することができる。先ず、シリコン粒子又はスズ粒子及び添加金属の金属粒子を混合し、粉砕機によってこれらの粒子の混合及び粉砕を同時に行う。粉砕機としてはアトライター、ジェットミル、サイクロンミル、ペイントシェイカ、ファインミルなどを用いることができる。粉砕前のこれらの粒子の粒径は20~500μm程度であることが好ましい。粉砕機による混合及び粉砕によってシリコン又はスズと添加金属とが均一に混ざり合った粒子が得られる。粉砕機の運転条件を適切にコントロールすることで得られる粒子の粒径を例えば40μm以下となす。これによってハ)の混合粒子が得られる。

シリコン系粒子又はスズ系粒子が、ニ)のシリコン又はスズと金属と の化合物粒子である場合、該化合物は、シリコン又はスズと金属との合 金を含み、1)シリコン又はスズと金属との固溶体、2)シリコン又はスズ 15 と金属との金属間化合物、或いは3)シリコン単相若しくはスズ単層、金 属単相、シリコン若しくはスズと金属との固溶体、シリコン若しくはス ズと金属との金属間化合物のうちの二相以上の相からなる複合体の何れ かである。前記金属としては、ハ)のシリコン又はスズと金属との混合 粒子に含まれる添加金属と同様のものを用いることができる。ニ)の化 合物粒子におけるシリコン又はスズと金属との組成は、ハ)の混合粒子 20 と同様にシリコン又はスズの量が30~99.9重量%で、金属の量が 0.1~70重量%であることが好ましい。更に好ましい組成は、化合 物粒子の製造方法に応じて適切な範囲が選択される。例えば該化合物 が、シリコン又はスズと金属との二元系合金であり、該合金を後述する 急冷法を用いて製造する場合、シリコン又はスズの量は40~90重 2.5 量%であることが望ましい。一方、添加金属の量は10~60重量%で あることが好ましい。

前記化合物がシリコン又はスズと金属との三元系以上の合金である場合には、先に述べた二元系合金に更にB、A1、Ni、Co、Sn、Fe、Cr、Zn、In、V、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される元素が少量含まれていてもよい。これによって、微粉化が抑制されるという付加的な効果が奏される。この効果を一層高めるため、これらの元素はシリコン又はスズと金属との合金中に0.01~10重量%、特に0.05~1.0重量%含まれていることが好ましい。

三)のシリコン又はスズと金属との化合物粒子が合金粒子である場合、該合金粒子は、例えば以下に説明する急冷法によって製造されることが、合金の結晶子が微細なサイズとなり且つ均質分散されることにより、微粉化が抑制され、電子伝導性が保持される点から好ましい。この急冷法においては、先ずシリコン又はスズと、添加金属とを含む原料の溶湯を準備する。原料は高周波溶解によって溶湯となす。溶湯におけるシリコン又はスズと添加金属との割合は前述した範囲とする。溶湯の温度は1200~1500℃、特に1300~1450℃とすることが急冷条件との関係で好ましい。鋳型鋳造法を用いてこの溶湯から合金を得る。即ち、該溶湯を銅製又は鉄製の鋳型に流し込んで、急冷されたシリコン系合金又はスズ系合金のインゴットを得る。このインゴットを粉砕し、

この鋳型鋳造法に代えてロール鋳造法を用いることもできる。即ち、溶湯を高速回転する銅製のロールにおける周面に対して射出する。ロールの回転速度は、溶湯を急冷させる観点から回転数 5 0 0 ~ 4 0 0 0 r p m、特に1000~2000 r p mとすることが好ましい。ロールの回転速度を周速で表す場合には、8~70 m/se と、特に15~30 m/se c であることが好ましい。前述の範囲の温度の溶湯を、前述範囲の速度で回転するロールを用いて急冷することで、冷却速度は10

²K/sec以上、特に10³K/sec以上という高速になる。射出された溶湯はロールにおいて急冷されて薄体となる。この薄体を粉砕、篩い分けして例えば粒径40μm以下のものを本発明に供する。この急冷法に代えて、ガスアトマイズ法を用い、1200~1500℃の溶湯に、アルゴンなどの不活性ガスを5~100atmの圧力で吹き付けて微粒化及び急冷して所望の粒子を得ることもできる。更に別法として、アーク溶解法やメカニカルミリングを用いることもできる。

活物質の粒子が、ホ)のシリコン又はスズと金属との化合物粒子と、 金属の粒子との混合粒子である場合、該化合物粒子としては、先に述べ たニ)の化合物粒子と同様の粒子を用いることができる。一方、金属の 10 粒子としては、先に述べたハ)の混合粒子に用いられる金属の粒子と同 様のものを用いることができる。化合物粒子に含まれる金属元素と、金 属の粒子を構成する金属元素とは同種でも異種でもよい。特に、化合物 粒子に含まれる金属元素がニッケル、銅、銀又は鉄であり、金属の粒子 を構成する金属元素がニッケル、銅、銀又は鉄であると、活物質層中に 15 これらの金属のネットワーク構造が形成されやすくなる。その結果、電 子伝導性の向上、活物質粒子の膨張収縮による脱落の防止等という有利 な効果が奏されるので好ましい。この観点から、化合物粒子に含まれる 金属元素と金属の粒子を構成する金属元素とは同種であることが好まし い。ホ)の活物質粒子は、先に述べたニ)の化合物粒子の製造方法と同 20 様の方法によって先ず化合物粒子を得て、この化合物粒子と金属の粒子 とを、先に述べたハ)の混合粒子の製造方法に従い混合することで得ら れる。化合物粒子中におけるシリコン又はスズと金属との割合は、先に 述べたニ)の化合物粒子中における両者の割合と同様とすることができ る。また化合物粒子と金属の粒子との割合は、先に述べたハ)の混合粒 子におけるシリコン又はスズの粒子と金属の粒子との割合と同様とする ことができる。これら以外でホ)の活物質粒子に関して特に説明しない 点については、先に述べたハ)の混合粒子又は二)の化合物粒子に関して詳述した説明が適宜適用される。

シリコン系粒子又はスズ系粒子が、へ)のシリコン単体又はスズ単体 の粒子の表面に金属が被覆されてなる粒子(この粒子を金属被覆粒子と いう)である場合、被覆金属としては、先に述べたハ)やニ)の粒子に 含まれる添加金属、例えば銅などと同様のものが用いられる(但しLi を除く)。金属被覆粒子におけるシリコン又はスズの量は70~99. 9 重量%、特に80~99重量%、とりわけ85~95であることが好 ましい。一方、銅を始めとする被覆金属の量は0.1~30重量%、特 に1~20重量%、とりわけ5~15重量%であることが好ましい。金 10 属被覆粒子は例えば無電解めっき法を用いて製造される。この無電解め っき法においては、先ずシリコン粒子又はスズ粒子が懸濁されており且 つ銅を始めとする被覆金属とを含むめっき浴を用意する。このめっき浴 中において、シリコン粒子又はスズ粒子を無電解めっきして該シリコン 粒子又はスズ粒子の表面に前記被覆金属を被覆させる。めっき浴中にお 15 けるシリコン粒子又はスズ粒子の濃度は400~600g/1程度とす ることが好ましい。前記被覆金属として銅を無電解めっきする場合に は、めっき浴中に硫酸銅、ロシェル塩等を含有させておくことが好まし い。この場合硫酸銅の濃度は6~9g/1、ロシェル塩の濃度は70~ 90g/1であることが、めっき速度のコントロールの点から好まし 20 い。同様の理由からめっき浴のpHは12~13、浴温は20~30℃ であることが好ましい。めっき浴中に含まれる還元剤としては、例えば ホルムアルデヒド等が用いられ、その濃度は15~30cc/1程度と することができる。

25 活物質粒子 7 がシリコン含有粒子である場合には、該シリコン含有粒子が前記イ) ~ホ)のうちのどのような形態であっても、その平均粒径 (D₅₀) が 0. 1~10 μ m であり、特に 0. 3~8 μ m、とりわけ 0.

8~5μmであることが好ましい。つまりこの活物質粒子は小粒径の微細粒子である(以下、この活物質粒子を小粒径活物質粒子という)。小粒径活物質粒子を用いることで、負極からの活物質粒子の脱落が一層起こりにくくなり、負極の長寿命化が可能となる。更に詳細には、活物質5粒子は、リチウムの吸蔵・放出時に著しい体積変化を伴うため、次第に微結晶化あるいは微粉化する。それに起因してクラックが発生し、一部の活物質粒子の電気化学的接触が失われる。このことは、二次電池として重要な特性である「充放電サイクル特性」の低下の要因となる。そこで当初から小粒径の微細粒子を負極に用いることにより、充放電時における粒子の更なる微粉化を抑制し、充放電サイクル特性を改善している。なお小粒径活物質粒子の平均粒径が前記の範囲の下限値未満となると、粒子の酸化が起こりやすくなる。またそのような微細粒子は製造コストが高いものとなる。小粒径活物質粒子の粒径は、レーザー回折散乱法、電子顕微鏡観察(SEM観察)によって測定される。

小粒径活物質粒子はその表面積が大きいことから、比較的大粒径の粒 15 子 (例えば数十μmのもの) に比べて酸化されやすい。活物質粒子が酸 化されることは、「充放電サイクル特性」と同様に二次電池として重要 な特性である「不可逆容量」増大の要因及び「充放電電流効率」低下の 要因となる。具体的には、小粒径活物質粒子中に酸素が多量に含まれて いると、電気化学的にインターカレートされたリチウムイオンが酸素原 20 子と強固な結合を形成し、放電時にリチウムイオンが解離されなくなっ てしまう。従って、小粒径活物質粒子は、比較的大粒径の粒子よりも厳 密に酸素濃度を管理する必要がある。具体的には小粒径活物質粒子は、 含有している酸素の濃度が好ましくは2.5重量%未満となっており、 更に好ましくは1.5重量%以下、一層好ましくは1重量%以下となっ 25 ている。これに対して比較的大粒径の粒子は表面積が大きくないことか ら、酸化に対してそれほどシビアになる必要がない。小粒径活物質粒子

25

に含まれる酸素の濃度は低ければ低いほど好ましい。勿論酸素を全く含まないことが最も好ましいが、小粒径活物質粒子の製造方法に鑑みると現在到達可能な酸素濃度の最低値は 0.005 重量%程度である。小粒径活物質粒子の酸素濃度は、測定対象試料の燃焼を伴うガス分析法によって測定される。

小粒径活物質全体での含有酸素濃度が前記の値未満であることに加えて、該小粒径活物質粒子は、粒子の最表面におけるSiの濃度が酸素の濃度の好ましくは1/2超となっており、更に好ましくは4/5以上、一層好ましくは10以上となっている。不可逆容量の増大及び充放電電10 流効率の低下は、小粒径活物質粒子における最表面の酸素濃度に主として左右されることが本発明者らの検討の結果判明した。その理由は、最表面に存在する酸素は、二次電池の充電の際にリチウムと反応しやすく、電池の特性を劣化させる原因となるからである。そこで、粒子の最表面におけるSiの濃度と酸素の濃度との比率を前記のように規定したものである。小粒径活物質粒子における表面酸素濃度はX線光電子分光分析装置(ESCA)やオージェ電子分光分析装置(AES)などを始めとする各種表面状態分析装置によって測定される。

なお、前記イ)~ホ)の何れの方法を用いる場合にも、酸素が混入しないような条件、例えば不活性ガス雰囲気下で小粒径活物質粒子を製造することが好ましい。

小粒径活物質粒子が前記イ)~ホ)の何れであっても、該小粒径活物質粒子は所定の粉砕方法によって前述の範囲の平均粒径となされる。粉砕法としては、乾式粉砕法及び湿式粉砕法が代表的なものである。乾式粉砕法においては例えばジェットミルなどが用いられる。一方、湿式粉砕法においては、ヘキサンやアセトンなどの有機溶媒を用いた粉砕溶媒中に粒子を分散させ、アルミナビーズやジルコニアビーズなどの粉砕

媒体を用いて粒子を粉砕する。

この粉砕操作によって小粒径活物質粒子が酸化される場合が多い。そ こで、粉砕操作後の小粒径活物質粒子(この粒子の平均粒径D50はO. 1~10μmとなっている)を、エッチング液を用いてエッチングして 該粒子の表面に存在する酸化物を除去することが好ましい。これによっ て、小粒径活物質粒子全体の酸素濃度及び粒子最表面の酸素濃度を容易 に前述した値以下とすることができる。エッチング液としては、例えば HF、バッファード酸、NH4F、KOH、NaOH、アンモニア又は ヒドラジンなどの水溶液が挙げられる。エッチングの程度は、エッチン 10 グ液の種類や濃度、エッチング液の温度、エッチング時間などによって 適宜制御できる。これにより、小粒径活物質粒子全体の酸素濃度及び粒 子最表面の酸素濃度を容易に前述した範囲内とすることができる。但 し、本工程において粒子表面の酸化物を完全に除去すべきではない。そ の理由は、酸化物を完全に除去された粒子は、大気に曝露されたときに 急激に酸化されてしまうからである。そのため本工程では酸化物が適度 15 に残留するようにエッチングの程度を調整することが好ましい。表面に 酸化物が適度に残留している粒子は、エッチング後の該粒子の表面及び 全体の酸素濃度を、大気に曝露された後でも概ね維持することができ る。

20 例えばHFでエッチングする場合、濃度1~50重量%程度のHF中に小粒径活物質粒子を投入し、室温で液を5~30分間程度撹拌することで、粒子最表面の酸素濃度を所望のレベルまで低下させることができる。KOHやNaOHでエッチングする場合には、濃度1~40重量%程度の水溶液中に小粒径活物質粒子を投入し、室温で液を5~120分間程度撹拌すればよい。アンモニアでエッチングする場合には、濃度1~20重量%程度の水溶液中に小粒径活物質粒子を投入し、室温で液を5~60分間程度撹拌すればよい。NH₄Fでエッチングする場合には、

濃度1~50重量%程度の水溶液中に小粒径活物質粒子を投入し、室温で液を5~60分間程度撹拌すればよい。ヒドラジンでエッチングする場合には、濃度1~50重量%程度の水溶液中に小粒径活物質粒子を投入し、室温で液を5~60分間程度撹拌すればよい。

5 以上説明した小粒径活物質粒子を含む負極は、充放電を繰り返しても 活物質粒子の微細化・微粉化の影響が少ない。その結果、充放電効率が 改善され、また不可逆容量が低減し、充放電サイクル特性が向上する。 また、小粒径活物質粒子中の酸素含有量を低下させることによっても、 不可逆容量が低減し、また充放電効率が向上し、充放電サイクル特性が 10 向上する。

小粒径活物質粒子はその表面が金属薄膜で被覆されていてもよい。金 属薄膜による被覆で小粒径活物質粒子の酸化が抑制され、不可逆容量の 増大及び充放電電流効率の低下が効果的に防止される。また電子伝導性 が向上し、充放電サイクル特性が一層改善される。

小粒径活物質粒子の酸化を効果的に抑制する観点及びLiとSiとの 反応を効率的に行う観点から、金属薄膜はその厚みが $0.05\sim4~\mu$ m、特に $0.05\sim0.5~\mu$ mであることが好ましい。金属薄膜の厚み は例えばESCAやAESによって測定される。

金属薄膜を構成する金属としては、リチウム形成能の低い金属を用い 20 ることが好ましい。そのような金属としては例えばNi、Cu、Co、 Fe、Ag又はAuが用いられ、特に酸化防止の点から、Ni、Co、 Ag、Auを用いることが好ましい。これらの金属はそれぞれ単体で又 は2種以上の組み合わせからなる合金として用いることができる。

金属薄膜で被覆された小粒径活物質粒子においては、金属薄膜と小粒

20

径活物質粒子との境界部における酸素濃度は、前述した小粒径活物質粒子に関して説明した通り、Siの濃度が酸素の濃度の1/2超となっている。なお、金属薄膜と小粒径活物質粒子との境界部は、金属薄膜で被覆された小粒径活物質粒子をAESによって分析し、金属薄膜を構成する金属の濃度が極小値となった部分と考える。

金属薄膜で被覆された小粒径活物質粒子の導電性を高める点からは、 金属薄膜最表面の酸素濃度は低い方が好ましい。

金属薄膜で被覆された小粒径活物質粒子は好ましくは次の方法で製造される。まず、先に説明した小粒径活物質粒子の製造方法に従い、乾式粉砕法や湿式粉砕法によって粒子を所定の大きさに粉砕した後、該粒子の表面に存在する酸化物をエッチングにより除去する。エッチング後の粒子を十分に水洗し、次いで無電解めっき工程に付して、粒子表面に金属薄膜を被覆する。無電解めっきに先立ち、粒子表面に通常のセンシタイジング処理及びアクティベーティング処理を施してもよい。無電解めっきの条件は、めっきする金属に応じて適宜適切に選択される。例えばNiめっきを行う場合の浴組成としては次のものが挙げられる。この場合、浴温は40~60℃程度とし、浴のpHは4~6程度とする。めっき時間は0.5~50分とする。

• N i S O₄ • 6 H₂O 1 5 ~ 3 5 g / 1 • N a H₂P O₂ • H₂O 1 0 ~ 3 0 g / 1 • N a $_3$ C $_6$ H $_5$ O $_7$ 1 5 ~ 3 5 g / 1

• N a $C_3H_5O_2$ 5 ~ 1 5 g / 1

小粒径活物質表面に形成される金属薄膜は粒子全体を完全に被覆していなくてもよい。例えば金属薄膜の厚さ方向に延びる多数の微細空隙が 25 該金属薄膜に存在するように、該金属薄膜が粒子表面をほぼ均一に万遍

なく被覆していてもよい。これにより、微細空隙を通じて電解液が小粒径活物質粒子の内部に到達するので、シリコン含有粒子が本来示す電気化学的反応を確実に起こすことができる。或いは、金属薄膜は粒子を島状に被覆していてもよい。

5 次に本実施形態の負極の第1の好ましい製造方法を、図4(a)ないし図4(d)を参照しながら説明する。先ず図4(a)に示すようにキャリア箔11を用意する。キャリア箔11の材質に特に制限はない。キャリア箔11は導電性であることが好ましい。この場合、導電性を有していれば、キャリア箔11は金属製でなくてもよい。しかし金属製のキャリア箔11を用いることで、電極10の製造後にキャリア箔11を溶解・製箔してリサイクルできるという利点がある。リサイクルの容易性を考慮すると、キャリア箔11の材質は、後述する電解めっきによって形成される表面層4の材質と同じであることが好ましい。キャリア箔11は、本実施形態の負極10を製造するための支持体として用いられるものであることから、製造工程においてヨレ等が生じないような強度を有していることが好ましい。従ってキャリア箔11は、その厚みが10~50μm程度であることが好ましい。

キャリア箔11は例えば電解や圧延で製造することができる。圧延で製造することで、表面粗さの低いキャリア箔11を得ることができる。表面粗さの低いキャリア箔11を用いることによって、後述する剥離層11aを形成しなくてもよくなるというメリットがある。一方キャリア箔11を電解によって製造することで、キャリア箔11の製造から負極10の製造までをインラインで行うことができる。インラインで行うことは、負極10の安定製造及び製造コストの低減の点から有利である。 25 電解によってキャリア箔11を製造する場合には、回転ドラムを陰極として用い、銅やニッケルなどの金属イオンを含む電解浴中で電解を行いドラム周面に金属を析出させる。析出した金属をドラム周面から剥離す ることでキャリア箔11が得られる。

キャリア箔11の表面粗さが低い場合には、キャリア箔11の表面上に直接活物質層3を形成することができる。また図4(a)に示すように、キャリア箔11の一面に剥離層11aを形成し、その上に活物質層53を形成してもよい。剥離層11aを形成することで、剥離を一層首尾良く行うことができる。また、キャリア箔11に防錆効果を付与できるという利点もある。剥離層11aを形成するか否かにかかわらずキャリア箔11の表面粗さRaは0.01~3μm、特に0.01~1μm、とりわけ0.01~0.2μmであることが好ましい。この程度の低表10 面粗さであれば、剥離を首尾良く行うことができ、また剥離層11aを形成する場合には、厚みのムラのない剥離層11aを形成する場合には、厚みのムラのない剥離層11aを形成する場合には、該剥離層11aによってキャリア箔11の表面粗さが減殺されるので、キャリア箔11の表面粗さが減殺されるので、キャリア箔11の表面粗さが減殺されるので、キャリア箔11aの表面粗さRaは前記の範囲よりも大きくても差し支えないこともある。

15 剥離層11aは、例えばクロムめっき、ニッケルめっき、鉛めっき、クロメート処理等によって形成される。また、特開平11-317574号公報の段落 [0037] ~ [0038] に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物、特開2001-140090号公報の段落 [0020] ~ [0023] に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物と銅微細粒と20 の混合物などによって形成されてもよい。これらのうち、剥離性が良好な点から、クロムめっき、ニッケルめっき、鉛めっき又はクロメート処理によって剥離層11aが形成されることが好ましい。この理由は、これらの処理等によって剥離層11aの表面に酸化物あるいは酸塩の層が形成され、この層は、キャリア箔11と後述する電解めっき層との密着25 性を低下させ剥離性を向上させる機能を有するからである。剥離層11aの厚みは0.05~3μmであることが、首尾良く剥離を行い得る点から好ましい。剥離層11aが形成された後の該剥離層11aの表面相

さRaは、キャリア箔 1 1 上に活物質層 3 を直接形成する場合と同様に、0. 0 1 \sim 3 μ m、特に0. 0 1 \sim 1 μ m、とりわけ0. 0 1 \sim 0. 2 μ m であることが好ましい。

電解によって製造されるキャリア箔11は、その製造方法に起因して その一方の面が平滑な光沢面となっており、他方の面が凹凸のあるマット面となっている。つまり各面の表面粗さが互いに異なっている。光沢面は、電解におけるドラム周面に対向していた面であり、マット面は析出面である。本製造方法においてキャリア箔11に剥離層11aを形成する場合、光沢面及びマット面のどちらに剥離層11aを形成していて もよい。剥離性が良好であることを考慮すると、表面粗さの低い光沢面上に剥離層11aを形成することが好ましい。マット面上に剥離層11aを形成する場合には、例えば特開平9−143785号公報に記載の電解液添加剤を用い電解を行い製造された箔を用いたり、剥離層11aの形成に先立ちマット面をエッチングすればよい。或いは圧延によって マット面の表面粗さを低下させればよい。

次に図4(b)に示すように剥離層11a上に、活物質の粒子を含む 導電性スラリーを塗布して活物質層3を形成する。なお剥離層11aを 形成しない場合にはキャリア箔11の表面に直接活物質層3を形成す る。スラリーは、活物質の粒子、導電性炭素材料や導電性金属材料の粒 3、結着剤及び希釈溶媒などを含んでいる。これらの成分のうち、結着 剤としてはポリビニリデンフルオライド(PVDF)、ポリエチレン(P E)、エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)などが用いられ る。希釈溶媒としてはNーメチルピロリドン、シクロヘキサンなどが用 いられる。スラリー中における活物質の粒子の量は14~40重量%程 度とすることが好ましい。導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子の 量は0.4~4重量%程度とすることが好ましい。結着剤の量は0.4 ~4重量%程度とすることが好ましい。また希釈溶媒の量は60~85

2.0

重量%程度とすることが好ましい。

スラリーの塗膜が乾燥して活物質層3が形成された後、該活物質層3 が形成されたキャリア箔11を、リチウム化合物の形成能の低い金属材 料を含むめっき浴中に浸漬して電解めっきを行う。めっき浴への浸漬に よってめっき液が活物質層3内に浸入して、活物質層3と剥離層11a との界面にまで達し、その状態下に電解めっきが行われる。その結果、 (a) 活物質層3の内部、(b) 活物質層3の外面側(即ちめっき液と 接している面側)及び(c)活物質層3の内面側(即ち剥離層11aと 対向している面側)において、リチウム化合物の形成能の低い金属材料 が析出して、各表面層4が形成されると共に表面層4を構成する材料が 10 活物質層3の厚み方向全域に亘って浸透して図1に示す構造の負極10 が得られる(図4(c)参照)。

電解めっきの条件としては、例えばリチウム化合物の形成能の低い金 属材料として銅を用いる場合、硫酸銅系溶液を用いるときには、銅の濃 15 度を30~100g/1、硫酸の濃度を50~200g/1、塩素の濃 度を30ppm以下とし、液温を30~80℃、電流密度を1~100 A/dm²とすればよい。ピロ燐酸銅系溶液を用いる場合には、銅の濃 度2~50g/1、ピロ燐酸カリウムの濃度100~700g/1と し、液温を30~60℃、pHを8~12、電流密度を1~10A/d m²とすればよい。これらの電解条件を適宜調節することで、表面層 4 を構成する材料が活物質層3の厚み方向全域に亘って浸透して両表面層 4 が電気的に導通するようになる。更に、表面層 4 中に、先に述べた多 数の微細空隙5が容易に形成される。

電解めっきによって表面層4に微細空隙5を形成する方法は、後述す るプレス加工による微細空隙の形成に比べて外力が加わらない方法なの 25 で、表面層4、ひいては負極10が損傷を受けることがないという利点

15

20

がある。表面層4の形成の際に微細空隙5が形成されるメカニズムは以下の通りであると本発明者らは推測している。即ち、活物質層3は活物質の粒子2を含む層であることから、活物質層3の表面はミクロの凹凸形状となっている。つまりめっきが成長しやすい活性サイトとそうでないサイトとが混在した状態となっている。このような状態の活物質層に電解めっきを行うと、めっきの成長にムラが生じ、表面層4の構成材料の粒子が多結晶状に成長していく。結晶の成長が進み、隣り合う結晶がぶつかるとその部分に空隙が形成される。このようにして形成された空隙が多数連なることによって微細空隙5が形成されると推測される。この方法によれば微細空隙5はその構造が極めて微細になる。

電極10が形成された後に、これをプレス加工して表面層4に微細空隙 5 を生じさせてもよい。十分な電子伝導性を得る観点から、プレス加工による圧密化は、プレス加工後の活物質層 3 と表面層 4 との厚みの総和が、プレス加工前の90%以下、好ましくは80%以下となるように行うことが好ましい。プレス加工には、例えばロールプレス機を用いることができる。プレス加工後の活物質層 3 には、先に述べた通り5~30体積%の空隙6が存在していることが好ましい。この空隙6の存在によって、充電時にリチウムを吸蔵して体積が膨張する場合に、その体積膨張に起因する応力が緩和される。このような空隙6はプレス加工の条件を前述のようにコントロールすればよい。この空隙6の値は、先に述べた通り電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。

本製造方法においては、電解めっきを行うに先立ち、活物質層 3 をプレス加工してもよい(このプレス加工を、先に述べたプレス加工と区別する意味で前プレス加工と呼ぶ)。前プレス加工を行うことで、活物質 層 3 と表面層 4 との剥離が防止され、また電極 1 0 の表面に活物質の粒子 2 が露出することが防止される。その結果、活物質の粒子 2 の脱落に起因する電池のサイクル寿命の劣化を防ぐことができる。更に、前プレ

ス加工を行うことで、表面層 4 を構成する材料の活物質 3 内への浸透の程度をコントロールできる(後述する実施例参照)。具体的には、プレスの程度が大きいと活物質の粒子 2 間の距離が短くなり、表面層 4 を構成する材料が活物質 3 内へ浸透しづらくなる。逆にプレスの程度が小さいと活物質の粒子 2 間の距離が長くなり、表面層 4 を構成する材料が活物質 3 内へ浸透しやすくなる。前プレス加工の条件としては、前プレス加工後の活物質層 3 の厚みが、前プレス加工前の活物質層 3 の厚みの 9 5 %以下、特に 9 0 %以下となるような条件であることが好ましい。

最後に、図4(d)に示すように、剥離層11aの部分において電極1010をキャリア箔11から剥離分離する。なお、図4(d)では剥離層11aがキャリア箔11側に残るように描かれているが、実際は剥離層11aはその厚さや剥離処理剤の種類によってキャリア箔11側に残る場合もあれば、電極10側に残る場合もある。或いはこれら双方に残る場合もある。何れの場合であっても、剥離層11aはその厚みが極めて場合もある。何れの場合であっても、剥離層11aはその厚みが極めて薄いので、得られる負極の性能に何ら影響はない。本製造方法に従い製造された負極の一例の構造を図5(a)及び図5(b)に示す。図5(a)と図5(b)とでは、使用した活物質の粒子径が異なり、図5(b)における活物質の粒子径の方が、図5(a)におけるそれよりも小さくなっている。

20 本製造方法によれば、活物質層 3 の形成操作を 1 回行うだけで、電極 の両面を電極反応に用い得る負極 1 0 が得られる。従来の負極において は、電極の両面を電極反応に用いるためには、集電用の厚膜導電体の両 面にそれぞれ活物質層を形成する必要があった。つまり活物質層の形成 操作を 2 回行う必要があった。従って、本製造方法によれば負極の製造 25 効率が極めて向上する。

また本製造方法によれば、負極10を電池に組み込むまではこれをキ

25

ャリア箔11から剥離せず、組み込む直前においてキャリア箔11から 剥離することで、薄くて皺になりやすい本実施形態の負極10を、ハン ドリング性良く搬送することができるという利点もある。

負極の第2の好ましい製造方法を、図6(a)ないし図6(f)を参 照しながら説明する。なお本製造方法に関し、特に説明しない点につい では、第1の製造方法に関する説明が適宜適用される。第2の製造方法 が第1の製造方法と異なる点は、本製造方法においては、キャリア箔1 1上に活物質層3を形成するに先立ち、キャリア箔11上にリチウム化 合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方の集電用表面層4 a を形成し、該集電用表面層4 a の上に活物質層3を形成し、活物質層3 の上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の 集電用表面層4 b を形成する点である。

先ず図6(a)に示すようにキャリア箔11を用意する。次に図6(b)に示すようにキャリア箔11の一面に薄い剥離層11aを形成する。本 15 製造方法においては光沢面およびマット面のどちらに剥離層11aを形成してもよい。

剥離層11aが形成されたら、図6(c)に示すように剥離層上に、リチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方の表面層4aを形成する。電解めっきの条件としては、第1の製造方法における電解めっきと同様の条件を用いることができる。この電解めっきによって、表面層4a中に先に述べた微細空隙を容易に形成することができる。引き続き、図6(d)に示すように表面層4a上に、活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層3を形成する。導電性スラリーが塗布される表面層4aの表面は析出面、つまりマット面であり、表面の粗度が高くなっている。このような表面状態になっている表面層4aの表面に導電性スラリーを塗布することで、活物質の粒子と表面層4aの表面に導電性スラリーを塗布することで、活物質の粒子と表面層4

25

aとの密着性が向上するという利点がある。

スラリーの塗膜が乾燥して活物質層 3 が形成された後、図 6 (e) に示すように該活物質層上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の集電用表面層 4 b を形成する。電解めっきの条件としては、第 1 の製造方法における電解めっきと同様の条件を用いることができる。当該電解条件を適宜調節することで、表面層 4 b が形成される。また、表面層 4 b を構成する材料が活物質層 4 の厚み方向全域に互って浸透して両表面層 4 a , 4 b が電気的に導通するようになる。更に、表面層 4 b 中に、先に述べた多数の微細空隙が容易に形成される。表面 10 層 4 b が形成された後に、活物質層 3 を表面層 4 a , 4 b ごとプレス加工して表面層 4 a , 4 b に微細空隙 5 を生じさせてもよい。また、活物質層 3 上に表面層 4 b を形成するに先立ち、活物質層 3 を前プレス加工してもよい。

最後に、図6 (f) に示すようにキャリア箔1を表面層4aから剥離15 分離する。これによって負極10が得られる。

なお図6(a)ないし図6(f)に示す工程図は模式図であるため、各表面層4a,4bが活物質層3と明確に分離しており、負極10が3層構造であるように表されている。しかし実際には、各表面層4a,4bどうしがつながった状態になっていることに留意すべきである。

第2の製造方法の別法として、図7(a)ないし図7(e)に示す第3の製造方法を用いることもできる。第3の製造方法においては、第2の製造方法における図6(c)に示す集電用表面層4aを形成するに先立ち、集電用表面層4aの構成材料と異質の材料からなる被覆体を、キャリア箔11上に0.001~1μmの厚さで形成し、その上に集電用

表面層の構成材料を電解めっきによって電析させて該集電用表面層 4 a を形成する。

先ず図7(a)に示すようにキャリア箔11を用意する。次に図7(b)に示すように、キャリア箔11の一面に、被覆体22を所定の手段によって被覆する。被覆前にキャリア箔11に酸洗浄等の前処理を施し、その表面を清浄にしておくことが好ましい。被覆体22は、表面層4aの形成面の電子伝導性を不均一な状態にすることで、表面層4aに多数の微細孔を形成するために用いられる。被覆体22は、その厚みが0.001~1μm、特に0.002~0.5μm、とりわけ0.005~0.2μmとなるように形成されることが好ましい。この程度の厚みにすることで、被覆体22は、キャリア箔11の表面を不連続に、例えば島状に被覆することになるからである。被覆体22を不連続に形成することは、表面層4aに微細空隙5を一層容易に形成する点から有利である。なお図7(b)においては、理解の助けとするため、被覆体22の大きさが強調されて描かれている。

被覆体22は、表面層4aの構成材料と異質の材料からなる。これによって後述する剥離工程において、キャリア箔11から表面層4aを首尾良く剥離することができる。特に被覆体22は、表面層4aの構成材料と異質の材料であって、且つCu、Ni、Co、Mn、Fe、Cr、Sn、Zn、In、Ag、Au、C、Al、Si、Ti及びPdのうちの少なくとも1種類の元素を含んで構成されていることが好ましい。

被覆体22の形成方法に特に制限はない。例えば、表面層4aの形成方法との関係で、被覆体22の形成方法を選択することができる。具体的には、表面層4aを電解めっきで形成する場合には、被覆体22も電25 解めっきで形成することが製造効率等の点から好ましい。尤も他の方法、例えば無電解めっき、スパッタリング法、物理気相蒸着法(PVD)、

化学気相蒸着法 (CVD)、ゾルゲル法又はイオンプレーティング法によって被覆体 2 2 を形成することも可能である。

電解めっきによって被覆体22を形成する場合には、被覆体22の構成材料に応じて適切なめっき浴やめっき条件が選択される。例えば被覆体22をスズから構成する場合には、めっき浴として以下の組成を有するものや、ほうふっ化スズ浴を用いることができる。このめっき浴を用いる場合の浴温は15~30℃程度であり、電流密度は0.5~10A/d m²程度であることが好ましい。

· S n S O₄

 $30 \sim 70 \text{ g} / 1$

10 · H₂SO₄

60~150g/l

・クレゾールスルホン酸 70~100g/l

先に述べた通り、被覆体22は、キャリア箔11における表面層4a の形成面の電子伝導性を不均一な状態にするために用いられる。従っ て、被覆体22の構成材料の電子伝導性がキャリア箔11の電子伝導性 と大きく異なれば、被覆体22を形成することで表面層4aの形成面の 15 電子伝導性が直ちに不均一な状態になる。例えば被覆体22の構成材料 としてカーボンを用いるような場合である。一方、被覆体22の構成材 料として、キャリア箔11と同程度の電子伝導性を有する材料、例えば スズ等を始めとする各種金属材料を用いた場合には、被覆体22の形成 によっては、表面層4aの形成面の電子伝導性が直ちに不均一な状態と 20 はならない。そこで、そのような材料から被覆体22を構成する場合に は、被覆体22が形成されたキャリア箔11を、乾燥状態下に含酸素雰 囲気、例えば大気中にさらすことが好ましい。これによって被覆体22 の表面(及びキャリア箔11の露出面)を酸化させる(図7(c)参照)。 この操作によって、表面層4aの形成面の電子伝導性が不均一な状態に 25 なる。この状態下に後述する電解めっきを行うと、被覆体22の表面と

キャリア箔11の露出面とで電析速度に差が生じ、表面層4aに微細空隙5を容易に形成することができる。酸化の程度は本発明において臨界的ではない。例えば、被覆体22が形成されたキャリア箔11を大気中に10~30分程度放置しておけば十分であることが本発明者らの検討によって判明した。尤も被覆体22が形成されたキャリア箔11を強制的に酸化させることは妨げられない。

被覆体22が形成されたキャリア箔11を、含酸素雰囲気にさらすときにこれを乾燥状態にする理由は、酸化を効率的に行うためである。例えば電解めっきによって被覆体22を形成した場合には、キャリア箔1101をめっき浴から引き上げた後にドライヤ等を用いてこれを乾燥させ、次いで所定時間大気中に放置すればよい。被覆体22の形成方法としてスパッタリング法や各種蒸着法等の乾式法を用いる場合には乾燥操作は不要であり、被覆体22の形成後、そのまま大気中に放置しておけばよい。

- 15 被覆体22を酸化させた後、図7(d)に示すように、その上に剥離層11aを形成する。剥離層11aは、剥離工程においてキャリア箔11から表面層4aを首尾良く剥離するために形成されるものである。従って、剥離層11aを形成しなくても、微細空隙を有する表面層4aを形成することができる。
- 20 次に図7(e)に示すように、剥離層11aを形成した上に、表面層 4aの構成材料を電解めっきによって電析させて表面層4aを形成す る。形成された金属箔4には、多数の微細空隙が形成されている。なお 図7(e)においては、被覆体22の頂点の位置に微細空隙が形成され ているように描かれているが、これは便宜的なものであり、実際には、 25 被覆体22の頂点の位置に必ず微細空隙が形成される訳ではない。めっ

き浴やめっき条件は、表面層4aの構成材料に応じて適切に選択され

る。例えば表面層 4 a を N i から構成する場合には、めっき浴として以下の組成を有するワット浴やスルファミン酸浴を用いることができる。 これらのめっき浴を用いる場合の浴温は 4 0 ~ 7 0 ℃程度であり、電流密度は 0 . 5 ~ 2 0 A / d m²程度であることが好ましい。

5 • N i SO₄ • 6 H₂O 1 5 0 \sim 3 0 0 g / 1 • N i C 1₂ • 6 H₂O 3 0 \sim 6 0 g / 1 • H₃BO₃ 3 0 \sim 4 0 g / 1

第3の製造方法における表面層4aの形成は、次に述べる別法1及び別法2を用いても行うことができる。別法1においては、炭素質材料の10 粒子を含む塗工液、例えばペーストなどを用意する。炭素質材料としては例えばアセチレンブラックなどを用いることができる。炭素質材料はその平均粒径D50(レーザー回折散乱法及び走査型電子顕微鏡観察の併用によって測定)が2~200mm、特に10~100mm程度であることが、微細空隙を容易に形成し得る点から好ましい。この塗工液を所定のキャリア箔11上に塗布する。塗布厚さは0.001~1μm、特に0.05~0.5μm程度であることが好ましい。次いで塗膜上に、表面層4aの構成材料を電解めっきによって電析させて表面層4aを形成する。電解めっきの条件は第3の製造方法におけるそれと同様とすることができる。

20 別法2においては、まず表面層4aの構成材料を含むめっき浴を用意する。例えば表面層4aをNiから構成する場合には、先に述べたワット浴やスルファミン酸浴を用意すればよい。このめっき浴に炭素質材料の粒子を加えて懸濁させる。炭素質材料としては別法1で用いられるものと同様のものを用いることができる。炭素質材料の粒径も別法1と同25 様とすることができる。めっき浴に懸濁させる炭素質材料の量は、0.5~50g/1、特に1~10g/1程度であることが、表面層4aに

10

微細空隙を容易に形成し得る点から好ましい。めっき浴を撹拌して炭素質材料を懸濁させた状態下に、キャリア箔11に対して電解めっきを行い表面層4aの構成材料を電析させて表面層4aを得る。

以上の各方法によって表面層 4 a が形成された後は、第 2 の製造方法 5 と同様の工程によって負極 1 0 が得られる。

以上説明した第 1 ないし第 3 の製造方法においては、活物質層 3 の形成後に電解めっきを行うに先立ち、先に述べた別法 1 に従い、平均粒径 D_{50} が $2\sim2$ 0 0 n m の炭素質材料を含む塗工液を 0 0 0 $1\sim1$ μ m の厚さで塗布し、その上に表面層 4 b の構成材料を電解めっきによって電析させて表面層 4 b を形成してもよい。これによって、表面層 4 b にも、多数の微細空隙を一層容易に形成することができる。

本実施形態の負極は、次に述べる第4の製造方法によっても製造することができる。まず、表面に多数の陽イオン交換基を有するキャリア樹脂を金属イオン含有液で処理して該陽イオン交換基の金属塩を生成させる。陽イオン交換基を有するキャリア樹脂としては、例えばポリイミド樹脂の表面を水酸化ナトリウムや水酸化カリウムなどのアルカリ水溶液で処理して、イミド環を開環して多数のカルボキシル基を生成させたのが挙げられる。アルカリ水溶液の濃度は3~10mo1/1程度が適当である。アルカリ水溶液の処理温度は20~70℃程度で、処理時間は3~10分程度でよい。アルカリ水溶液で処理されたポリイミド樹脂は酸で中和されることが好ましい。なお、ポリイミド樹脂のアルカリ処理による開環及び金属被膜の形成の詳細は、特開2001-73159号公報に記載されている。

生成した金属塩を還元剤で還元する。還元剤としては水素化ホウ素ナ 25 トリウム、次亜リン酸及びその塩などが挙げられる。還元によってキャ リア樹脂の表面に触媒核となる前記金属の被膜が形成される。次いで該 被膜上に電解めっきを行い一方の集電用表面層を形成する。引き続き表 面層の上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形 成する。更に活物質層の更に電解めっきを行い他方の集電用表面層を形 成する。然る後、キャリア樹脂を剥離するか又は有機溶剤を用いてキャ リア樹脂を溶解して、該キャリア樹脂を一方の集電用表面層から分離す る。これによって本実施形態の負極が得られる。なお、本製造方法に関 し特に説明しない点については、先に述べた第1ないし第3の製造方法 に関する説明が適宜適用される。

このようにして得られた本実施形態の負極10は、公知の正極、セパ 10 レータ、非水系電解液と共に用いられて非水電解液二次電池となされ る。正極は、正極活物質並びに必要により導電剤及び結着剤を適当な溶 媒に懸濁し、正極合剤を作製し、これを集電体に塗布、乾燥した後、ロ ール圧延、プレスし、さらに裁断、打ち抜きすることにより得られる。 正極活物質としては、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムマンガン 15 複合酸化物、リチウムコバルト複合酸化物等の従来公知の正極活物質が 用いられる。セパレーターとしては、合成樹脂製不織布、ポリエチレン 又はポリプロピレン多孔質フイルム等が好ましく用いられる。非水電解 液は、リチウム二次電池の場合、支持電解質であるリチウム塩を有機溶 媒に溶解した溶液からなる。リチウム塩としては、例えば、LiC1O 20 4, LiA1Cl₄, LiPF₆, LiAsF₆, LiSbF₆, LiSCN, LiC1、LiBr、LiI、LiCF3SO3、LiC4F9SO3等が例 示される。

次に、本発明の負極の第2の実施形態について図8を参照しながら説 95 明する。本実施形態については、第1の実施形態と異なる点についての み説明し、特に説明しない点については、第1の実施形態に関して詳述 した説明が適宜適用される。また、図8において、図1と同じ部材に同 10

25

じ符号を付してある。

図8に示すように本実施形態の負極は、厚さ方向の中央部に、芯材としての導電性金属箔層8を備えている。金属箔層8の各面には活物質層3,3がそれぞれ形成されている。更に各活物質層3,3被覆する集電用表面層4a,4bがそれぞれ形成されている。

各活物質層 3, 3においては、集電用表面層 4 a, 4 b を構成する材料が各活物質層 3, 3の厚み方向全域に亘ってそれぞれ浸透している。活物質の粒子 2 は電極の表面に露出しておらず各表面層 4 a, 4 b の内部に包埋されている。各表面層 4 a, 4 b を構成する。集電用表面層 4 a, 4 b を構成する材料は、各活物質層 3, 3 をその厚み方向に貫いており金属箔層 8 とでながっている。それによって各表面層 4 a, 4 b は金属箔層 8 と電気的に導通することになり、負極全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施形態の負極も第1の実施形態の負極と同様に、負極全体が一体として集電機能を有する。

本実施形態の負極の製造方法の概略を説明すると次の通りである。先 ず金属箔層 8 の各面に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活 物質層をそれぞれ形成する。金属箔層 8 は予め製造しておいてもよく、 或いは本実施形態の負極の製造工程における一工程としてインラインで 製造されてもよい。金属箔層 8 がインラインで製造される場合、電解析 出によって製造されることが好ましい。スラリーの塗膜が乾燥して活物質層が形成された後、該活物質層が形成された金属箔層 8 を、リチウム化合物の形成能の低い金属材料を含むめっき浴中に浸漬し、その状態下に活物質層上に該導電性材料による電解めっきを行い表面層 4 a , 4 b を形成する。この方法を用いることで、表面層 4 a , 4 b に多数の微細空隙を容易に形成することができる。また、表面層 4 a , 4 b を構成する導電性材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して、両表面層が金属箔層 8 と電気的に導通する。

本発明は前記実施形態に制限されない。例えば前記実施形態において 10 は、集電用表面層 4 を構成する材料が活物質層 3 をその厚み方向に貫い て、両表面層 4 が電気的に導通していたが、各表面層 4 の集電性を十分 に確保できる限度において、両表面層 4 は電気的に導通していなくても よい。

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発 15 明の範囲はかかる実施例に制限されるものではない。以下の例中、特に 断らない限り「%」は「重量%」を意味する。

[実施例1-1]

(1)活物質粒子の製造

シリコン80%、ニッケル20%を含む1400℃の溶湯を、銅製の 20 鋳型に流し込んで、急冷されたシリコンーニッケル合金のインゴットを 得た。このインゴットをジェットミルで粉砕し篩い分けして活物質粒子 を得た。この粒子の平均粒径(D₅₀値)は5μmであった。

(2) スラリーの調製

以下の組成のスラリーを調製した。

25 ・前記(1)で得られた活物質粒子

16%

41

・アセチレンブラック (粒径 0.1 μm) 2%

・結着剤 (ポリピニリデンフルオライド) 2%

・希釈溶媒 (N-メチルピロリドン) 80%

(3)剥離層の形成

電解によって得られた銅製のキャリア箔(厚さ35μm、表面粗さR a 0.1μm)の表面をクロメート処理して厚さ0.5μmの剥離層を 形成した(図4(a)参照)。剥離層の表面粗さRaも0.1μmであった。

(4)活物質層の形成

10 キャリア箔における剥離層上に前記スラリーを塗工し乾燥させて活物質層を形成した(図4(b)参照)。次いで0.5 t/cmの圧力でロールプレス加工(前プレス加工)し活物質層を圧密化させた。このようにして得られた活物質層の厚みは8μmであった。

(5)集電用表面層の形成

15 活物質層が形成されたキャリア箔を、以下の組成を有するめっき浴中 に浸漬し、電解めっきを行った。

· 銅 5 0 g / 1

·硫酸 60g/1

・浴温 40℃

20 電流密度を20A/dm²として70秒間電解めっきした後、キャリア箔をめっき浴から引き上げ負極を得た(図4(c)参照)。キャリア箔と接する側の集電用表面層(以下、こちら側の表面層を第1表面層という)の厚さは1μmであり、キャリア箔と接しない側の集電用表面層(以下、こちら側の表面層を第2表面層という)の厚さは1μmであった。

(6) キャリア銅箔の剥離

図4 (d)に示すように、剥離層の部分において、負極をキャリア箔をから剥離した。これによって図1に示す構造の負極を得た。各表面層には、該表面層の表面において開孔し且つ活物質層と通ずる多数の微細空隙が存在していた。微細空隙の平均開孔面積及び開孔率は表1-1に示す通りであった。

[実施例1-2]

電解めっきの時間を60秒とした以外は実施例1-1と同様にして負極を得た。第1表面層の厚みは1μmであり、第2表面層の厚みは0.

5μmであった。各表面層には、該表面層の表面において開孔し且つ活物質層と通ずる多数の微細空隙が存在していた。微細空隙の平均開孔面積及び開孔率は表1-1に示す通りであった。

[実施例1-3]

電解めっきの時間を130秒とした以外は実施例1-1と同様にして 15 負極を得た。第1表面層の厚みは1μmであり、第2表面層の厚みは5 μmであった。各表面層には、該表面層の表面において開孔し且つ活物 質層と通ずる多数の微細空隙が存在していた。微細空隙の平均開孔面積 及び開孔率は表1-1に示す通りであった。

[実施例1-4]

20 スラリー塗工後のロールプレス加工(前プレス加工)を1 t/cmの 圧力で行い、且つ電解めっきの時間を50秒とした以外は実施例1-1 と同様にして負極を得た。第1表面層の厚みは0.5 μmであり、第2 表面層の厚みは0.5 μmであった。各表面層には、該表面層の表面に おいて開孔し且つ活物質層と通ずる多数の微細空隙が存在していた。微 25 細空隙の平均開孔面積及び開孔率は表1-1に示す通りであった。

[実施例1-5]

スラリー塗工後のロールプレス加工(前プレス加工)を1 t/cmの圧力で行い、且つ電解めっきの時間を120秒とした以外は実施例1-1と同様にして負極を得た。第1表面層の厚みは0.5 μmであり、第2表面層の厚みは5 μmであった。各表面層には、該表面層の表面において開孔し且つ活物質層と通ずる多数の微細空隙が存在していた。微細空隙の平均開孔面積及び開孔率は表1-1に示す通りであった。

[比較例1-1]

(1) スラリーの調製

10 以下の組成のスラリーを調製した。

希釈溶媒(Nーメチルピロリドン)

・グラファイト粉末(粒径10μm)	1	6 %
・アセチレンブラック(粒径0.1μm)		2 %
・結着剤(ポリピニリデンフルオライド)		2 %

15 (2)厚さ30μmの銅箔の各面上に、調製されたスラリーそれぞれを 塗工し乾燥させて活物質層を形成した。次いで0.5 t/cmの圧力で ローラープレス加工し負極を得た。プレス加工後の各活物質層の厚みは

80%

〔性能評価〕

 $20 \mu m$ σb σc

実施例及び比較例で得られた負極を用いて以下の通り非水電解液二次電池を作製した。以下の方法で不可逆容量、最大容量が得られるまでに要したサイクル数(以下、最大容量が得られたサイクル数という)、最大容量が得られたサイクル数における重量あたり容量密度(以下、重量あたり最大容量密度という)、最大容量が得られたサイクル数における
 体積あたり容量密度(以下、体積あたり最大容量密度という)、50サイクル時の容量維持率を測定した。これらの結果を以下の表1-1に示

す。

[非水電解液二次電池の作製]

対極として金属リチウムを用い、また作用極として前記で得られた負極を用い、両極をセパレーターを介して対向させた。更に非水電解液としてLiPF₆/エチレンカーポネートとジエチルカーポネートの混合溶液(1:1容量比)を用いて通常の方法によって非水電解液二次電池を作製した。

[不可逆容量]

不可逆容量(%)=(1-初回放電容量/初回充電容量)×100 10 すなわち、充電したが放電できず、活物質に残存した容量を示す。

[最大容量が得られたサイクル数]

充放電を開始した後、最大の放電容量が得られたサイクル数を示す。 初期の活性が悪い電極ほど最大容量が得られるサイクル数は大きくな る。

15 [重量あたり最大容量密度]

最大容量が得られたサイクル数における、負極重量あたりの放電容量を示す。単位はmAh/gである。なお一般には、活物質重量あたりの放電容量を示す場合が多いが、ここでは厚膜集電体を用いないことの優位性を明らかにするため負極重量あたりの放電容量を示した。

20 [体積あたり最大容量密度]

最大容量が得られたサイクル数における、負極体積あたりの放電容量を示す。単位はmAh/cm³である。なお一般には、活物質体積もしくは活物質層体積あたりの放電容量を示す場合が多いが、ここでは厚膜集電体を用いないことの優位性を明らかにするため負極体積あたりの放

電容量を示した。

[50サイクル時の容量維持率]

200

50 サイクル時の容量維持率(%) = 50 サイクル目の放電容量/最大放電容量×100

11/18

5

表1-1に示す結果から明らかなように、各実施例の負極は、不可逆容量が小さいことが判る。また最大容量が得られたサイクル数が小さく、充放電の初期段階から充放電容量が高いことが判る。また重量あたり及び体積あたりの容量密度が極めて高いことが判る。更に充放電を繰り返した後の容量維持率が高く、サイクル寿命が長くなることが判る。なお表には示していないが、各実施例の負極においては、各表面層を構成する材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して、両表面層が電気的に導通していた。また、活物質の粒子は負極の表面に実質的に露出しておらず表面層の内部に包埋されていた。

10 〔実施例2-1及び2-2〕

(1)剥離層の形成

厚さ35μmの電解銅箔をキャリア箔として用いた。このキャリア箔を、室温において30秒間酸洗液中で洗浄した。引き続き室温において30秒間純水洗浄した。次いで、40℃に保たれた3g/1のカルボキシベンゾトリアゾール溶液中にキャリア箔を30秒間浸漬して図6(b)に示すように剥離層を形成した。更に、室温において15秒間純水洗浄した。

- (2)第1の表面層の形成 以下の浴組成を有するニッケルめっき浴にキャリア箔を浸漬させて電解を行い、図6 (c)に示すように、極薄ニッケル箔からなる第1の表面層を形成した。第1の表面層は、キャリア箔における光沢面側に形成された剥離層上に形成した。電流密度は $5A/dm^2$ 、浴温は50 Cとした。陽極にはニッケル電極を用いた。電源は直流電源を使用した。第1の表面層の膜厚は実施例2-1においては 3μ m、実施例2-2においては 1μ mとした。
- 25 ニッケルめっき浴組成

 $N i SO_4 \cdot 6 H_2O$

250g/L

48

N i C l $_2$ · 6 H $_2$ O 4 5 g / L H $_3$ B O $_3$ 3 0 g / L

(3)活物質層の形成

第1の表面層の形成後、30秒間純水洗浄を行い、次いで大気中で乾燥させた。次に、第1の表面層上に、活物質の粒子を含むスラリーを塗布して、図6(d)に示すように、膜厚15μmの活物質層を形成した。活物質の粒子として、平均粒径D50が1.5μmであるSi80%-Ni20%の組成を有する合金粉を用いた。スラリーは、活物質の粒子、ニッケル粉、アセチレンブラック及びポリビニリデンフルオライド(以下PVdFという)を含むものであった。スラリー組成は、活物質:ニッケル粉:アセチレンブラック:PVdF=60:34:1:5であった。

(4)第2の表面層の形成 図6(e)に示すように、活物質層上に、極薄ニッケル箔からなる第2の表面層を電解によって形成した。電解の 15条件は第1の表面層の形成条件と同様とした。但し膜厚が3μmとなる ように電解を行った。

(5)電極の剥離

このようにして得られた電極を、図6 (f) に示すように、キャリア 箔から剥離して本発明の負極とした。実施例2-1で得られた負極の断 20 面の電子顕微鏡写真を図9に示す。

[実施例2-3及び2-4]

第1の表面層としての極薄銅箔を電解により形成した。浴組成は以下の通りであった。電流密度は $20\,A/d\,m^2$ 、浴温は $40\,C$ とした。陽極には寸法安定化アノードを用いた。電源は直流電源を使用した。第1の表面層の膜厚は実施例 $2-3\,C$ おいては $3\,\mu\,m$ 、実施例 $2-4\,C$ おい

ては $1~\mu$ m とした。次いで、第 $1~\sigma$ 表面層を防錆処理する目的で、2~5~% に保たれた $1~g~/1~\sigma$ ベンゾトリアゾール溶液によって第 $1~\sigma$ 表面層を 1~0~秒間処理した。これら以外は実施例 2~-1~と同様にして負極を得た。

5 銅めっき浴組成

 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

250g/L

 H_2SO_4

20

70g/L

[実施例2-5]

実施例 2-1 で用いたスラリーと同様のスラリーを、厚さ 35μ mの 電解銅箔の各面に、厚さが各々 15μ mとなるように塗工し、乾燥させて活物質層を形成した。次いで、実施例 2-1 と同様の浴組成を有するニッケルめっき浴に浸漬させて電解を行い、図 8 に示すように極薄ニッケル箔からなる表面層をそれぞれ形成した。電解の条件は実施例 2-1 と同様とした。各表面層の膜厚はそれぞれ 3μ mとした。このようにして図 8 に示す負極を得た。

[比較例2-1]

グラファイト粉末(平均粒径 D_{50} = 10μ m):アセチレンブラック(平均粒径 D_{50} =40nm):PVdF:N-メチルピロリドン=16:2:2:80の混合比(重量比)のスラリーを調製した。厚さ 35μ mの銅箔の各面にスラリーを塗工し乾燥させて活物質層を形成した。次いで0.5t/cmの圧力でローラープレス加工した。プレス加工後の活物質層の片面の厚さは 40μ mであった。このようにして負極を得た。

[比較例2-2]

実施例2-1で用いたスラリーと同様のスラリーを、厚さ35μmの 25 銅箔の各面に、厚さが各々15μmとなるように塗工し、乾燥させて活 物質層を形成した。このようにして負極を得た。

[性能評価]

実施例及び比較例にて得られた負極を用い、以下の方法で非水電解液 二次電池を作製した。この電池の最大負極放電容量、電池容量及び50 サイクル時の容量維持率を以下の方法で測定、算出した。これらの結果 を以下の表2-1に示す。また、実施例2-1並びに比較例2-1及び 2-2で得られた負極を作用極として用い、対極に金属リチウムを用い て非水電荷液二次電池を作製して、充放電サイクル数に対する放電容量 の変化を測定した。その結果を図12に示す。

10 [非水電解液二次電池の作製]

実施例及び比較例で得られた負極を作用極とし、対極としてLiCo O_2 を用い、両極をセパレーターを介して対向させた。非水電解液としてLiPF $_6$ /エチレンカーボネートとジエチルカーボネートの混合液 (1:1容量比)を用いて通常の方法によって非水電解液二次電池を作製した。

[最大負極放電容量]

最大容量が得られたサイクルにおける、活物質重量当たりの放電容量を測定した。単位はmAh/gである。

[電池容量]

15

20 負極の厚さ及び面積から体積を求め、単位体積当たりの容量を算出した。比較例 2 - 1 の電極を負極として用いた電池の容量を 1 0 0 とし、他の電池の容量を相対表示した。

[50サイクル時の容量維持率]

50サイクル目の放電容量を測定し、その値を2サイクル目以降の最 25 大負極放電容量で除し、100を乗じて算出した。

表2-

	活物質組成	第1の表面層 材質/厚さ	第2の表面層 材質/厚さ	最大負極 放電容量 (mAh/g)	電池容量 (vs 比較例 1)	50 サイクル時の 容量維持率 (%)
実施例 2-1	SigoNi20	Ni/3 µ m	Ni/3μm	3150	150	86
実施例 2-2	SigoNizo	Ni/1 m	Ni/3 µ m	3130	160	96
実施例 2-3	SigoNi20	w # €/n9	Ni/3 µ m	3120	150	95
実施例 2-4	SigoNizo	Gu/1μm	m η ε/ i N	3120	160	88
実施例 2-5	Signizo		Ni/3 µ m	3150	120	86
比較例 2-1	ວ	1	l	300	100	100
比較例 2-2	SigoNi20	1	t	3140	130	15

表2-1に示したように、各実施例で得られた電極を用いた二次電池 は、各比較例で得られた電極を用いた二次電池よりも、最大負極放電容 量、電池容量及び50サイクル時の容量維持率が高くなることが判る。 また図12に示す結果から明らかなように、実施例2-1の負極は、充 放電を繰り返しても放電容量が低下せず高いレベルを維持していること が判る。これに対し、比較例2-1の負極は、放電容量が極めて低いレ ベルである。比較例2-2の負極は、初期の放電容量は比較的高いレベ ルであるものの、充放電の繰り返しによって放電容量が急激に低下する ことが判る。なお、表には示していないが、電子顕微鏡観察の結果、実 施例2-1~2-4の負極では、表面層の構成材料が活物質層の厚み方 10 向の全域に耳って浸透し、両表面層が電気的に導通していることが確認 された。実施例2-5の負極では、表面層の構成材料が活物質層の厚み 方向の全域に亘って浸透し、銅箔と電気的に導通していることが確認さ れた。更に実施例2-1~2-5の負極では、表面層に、該表面層の厚 さ方向に延びる微細空隙が多数形成されていることを確認した。 15

[実施例3-1]

25 · S n S O₄

20

50g/1

• H₂SO₄

- 100g/l
- ・クレゾールスルホン酸 100g/1

被覆体が形成されたキャリア箔を、40℃に保たれた3g/1のカルボキシベングトリアゾール溶液中に30秒間浸漬した。これにより剥離層形成処理を行った。剥離層形成処理後、溶液から引き上げて15秒間純水洗浄した。

5 次に以下の浴組成を有するワット浴にキャリア箔を浸漬させて電解めっきを行いニッケルからなる第1の表面層を形成した。電流密度は5 A / d m²、浴温は50℃とした。陽極にはニッケル電極を用いた。電源は直流電源を用いた。表面層は3 μ m の厚さに形成した。めっき浴から引き上げた後、30秒間純水洗浄して大気中で乾燥させた。このようにして得られた表面層の走査型電子顕微鏡写真及び光を透過させた状態での写真を図9(a)及び図9(b)に示す。

• N i S O₄ • 6 H₂O 2 5 0 g / 1 • N i C l₂ • 6 H₂O 4 5 g / 1 • H₃B O₃ 3 0 g / 1

次に、表面層上に負極活物質の粒子を含むスラリーを膜厚 $15\mu m$ になるように塗布し活物質層を形成した。活物質粒子はSi80wt%-Ni20wt%の組成を有する合金であり、平均粒径は $D_{50}=1.5\mu$ mであった。スラリーの組成は、活物質:Ni%:アセチレンブラック:ポリピニリデンフルオライド=60:34:1:5であった。

20 活物質層上に、平均粒径 D_{50} が40nmの炭素質材料(アセチレンブラック)を含むペーストを膜厚 $0.5\mum$ になるように塗布した。引き続き、この塗膜上に、前述した電解条件と同条件で電解めっきを行いニッケルからなる第2の表面層を形成した。表面層は $3\mum$ の厚さに形成した。

最後に、第1の表面層とキャリア箔とを剥離して、一対の表面層間に 活物質層が挟持されてなる非水電解液二次電池用負極を得た。

〔性能評価〕

実施例で得られた負極について以下の方法で充電特性を評価した。そ 5 の結果を図10(a)及び図10(b)に示す。図10(a)はキャリ ア箔から剥離した表面層側(第1の表面層側)の充電特性を示し、図1 0(b)は被覆めっき側(第2の表面層側)の充電特性を示す。また、 実施例で得られた負極における第1及び第2の表面層に形成された微細 空隙の直径及び存在密度を以下の方法で測定した。その結果を以下の表 10 3-1に示す。

〔充電特性の評価方法〕

対極として金属リチウムを用い、また作用極として実施例で得られた電極を用い、両極をセパレーターを介して対向させた。非水電解液としてLiPF₆/エチレンカーボネートとジエチルカーボネートとの混合 7 溶液 (1:1容量比)を用い、通常の方法によって非水電解液二次電池を作製した。この電池を用い、充電条件 0.2 m A / c m²、電圧範囲 0~2.8 Vにて評価を行った。

[微細空隙の直径及び存在密度の測定方法]

第1の表面層のみが形成されたキャリア箔から該表面層を剥離し、暗 20 室にて表面層の裏側から光を透過させ、その状態下に表面層の写真を撮 影した。その写真を画像解析することにより微細空隙の直径及び存在密 度を求めた。

表 3 一 1

	微細孔の	3 箔 (キャリア箔 存在密度 /cm²)	剥離側)	微細孔の	箔 (被覆め 存在密度 cm ²)	っき側)
	微細孔の 直径 0.01μm 以上 10μm 以下	微細孔の 直径 10μm超 200μm 以下	厚さ (μm)	微細孔の 直径 0.01μm 以上 10μm 以下	微細孔の 直径 10μm超 200μm 以下	厚さ (μm)
実施例 3-1	670	0	3	550	0	3

表3-1及び図10に示す結果から明らかなように、実施例の負極ではキャリア箔剥離側及び被覆めっき側ともに十分な容量が得られていることが判る。このことは、実施例の負極では第1及び第2の表面層を通じて電解液が活物質層に十分に供給されていることを意味している。

[実施例4-1]

5

10

(1)活物質粒子の製造

シリコン80%、ニッケル20%を含む1400℃の溶湯を、銅製の 鋳型に流し込んで、急冷されたシリコンーニッケル合金のインゴットを 得た。このインゴットをジェットミルで粉砕し篩い分けして活物質粒子 を得た。得られた活物質粒子を20%のKOH中に投入し、20分間エ ッチングした。活物質粒子の平均粒径、総酸素濃度及び最表面O/Si 比を表4-1に示す。

(2) スラリーの調製

以下の組成のスラリーを調製した。

15 ・前記 (1) で得られた活物質粒子

- 16%
- ・アセチレンブラック(粒径0.1μm)
- 2 %

56

結着剤(ポリビニリデンフルオライド)

2 %

・希釈溶媒(Nーメチルピロリドン)

80%

(3) 第1の集電用表面層の形成

図 6 (b) に示すように、厚さ 3 5 μ m のキャリア銅箔上に、カルボ キシベンプトリアゾールからなる剥離層を形成した。次いで図 6 (c) に示すように、剥離層上にNiめっきを施して厚さ 3 μ m の第 1 の集電 用表面層を形成した。

(4)活物質層の形成

図6 (d) に示すように、第1の集電用表面層上にスラリーを塗工し 10 乾燥させた。乾燥後の塗工厚みは10μmであった。

(5) 第2の集電用表面層の形成

図 6 (e) に示すように、活物質層上にNiめっきを施して厚さ 3μ m の第 2 の集電用表面層を形成した。

(6) キャリア銅箔の剥離

25 図6(f)に示すように、剥離層の部分においてキャリア銅箔を第1 の集電用表面層から剥離した。これによって図1に示す構造の負極を得 た。

[実施例4-2]

エッチング液としてKOHに代えてHFを用いた以外は実施例4-1 20 と同様にして活物質粒子を得た。HFの濃度は5%、エッチング時間は 10分であった。その後は実施例4-1と同様にして負極を得た。

[実施例4-3]

エッチング液としてKOHに代えてNH4Fを用いた以外は実施例1

と同様にして活物質粒子を得た。 NH_4F の濃度は5%、エッチング時間は10分であった。その後は実施例4-1と同様にして負極を得た。

[実施例4-4]

エッチング液としてKOHに代えてヒドラジンを用いた以外は実施例 4-1と同様にして活物質粒子を得た。ヒドラジンの濃度は1%、エッチング時間は60分であった。その後は実施例4-1と同様にして負極を得た。

[実施例4-5及び4-6]

実施例4-1で得られた活物質粒子をNiで無電解めつき処理してNi薄膜を形成した。Ni薄膜の厚みは表4-2に示す通りであった。その後は実施例4-1と同様にして負極を得た。無電解めっきの浴組成は以下の通りであった。

 \cdot N i SO₄ \cdot 6 H₂O 2 5 g / 1

• Na H₂PO₂ • H₂O 2 0 g / 1

 $_{15}$ · N a $_{3}$ C $_{6}$ H $_{5}$ O $_{7}$ 2 5 g / 1

• N a C $_{3}$ H $_{5}$ O $_{2}$ 1 0 g / 1

[実施例4-7及び4-8]

実施例4-2で得られた活物質粒子をNiで無電解めっき処理してNi薄膜を形成した。Ni薄膜の厚みは表4-2に示す通りであった。そ20 の後は実施例4-1と同様にして負極を得た。無電解めっきの浴組成は実施例4-5と同様であった。

[実施例4-9]

実施例4-8で得られた活物質粒子を用い、実施例4-1と同様の方法によってスラリーを調製した。調製されたスラリーを、厚さ18μm

の銅箔の各面に塗工し乾燥させた。乾燥後の活物質層の厚みはそれぞれ 1 0 μmであった。活物質層が形成された銅箔をNiめっき浴中に浸渍 し、各活物質層上にNiを電解めっきした。これによって図8に示す構造の負極を得た。

5 〔性能評価〕

各実施例で得られた負極を用いて、以下の通り非水電解液二次電池を作製した。この電池について上述の方法で最大放電容量及び50サイクル容量維持率を測定した。これらの結果を以下の表4-1及び表4-2に示す。また、実施例4-5~4-9について、負極製造時における第2の集電用表面層形成の際のめっき電流効率を求めた。めっき電流効率は、活物質粒子の酸素濃度が低いほど100%に近づく。

[非水電解液二次電池の作製]

対極として金属リチウムを用い、また作用極として前記で得られた負極を用い、両極をセパレーターを介して対向させた。更に非水電解液としてLiPF₆/エチレンカーボネートとジエチルカーボネートの混合溶液(1:1容量比)を用いて通常の方法によって非水電解液二次電池を作製した。

	掛					
電俗性	509/1/II 容量維持率 %	95	97	6	92	
電極充放電俗性	最大放電容量 mAh/g	2500	2500	2500	2500	·
破素膜皮	最表面0/Si比 ^{%2}	0.4	0.3	0.3	0.4	
類	総酸素量/wt% ^{%1}	0.7	0.5	0.5	0.7	
	組成	Si80+Ni20	S:80+N:20	S:80+N:20	S:80+N:20	
平均粒径	D50 μ m	2.5	2.0	2.0	2.5	酸素ガス分析 オージュ電子分光法 エッチングなし
		実施例4-1	実施例4-2	実施例4-3	実施例4-4	※1 酸素力 ※2 オージェ ※3 Hッカ

	82 TA TA SE		酸素	酸素濃度	1	めっき	電極充放電特性	電特性
	平均和企 D50 μm*³	組成	総酸素量 wt% ^{※1}	金属薄膜境界 0/Si比※2	田原甲はなる。	電效流率%	最大放電容量 mAh/g	5044916 容量能持率 %
実施例4-5	2.5	S:80+N:20	0.7	0.4	0.05	85	2500	96
実施例4-6	2.5	S:80+N:20	0.7	0.4	0.5	88	2500	16
実施例4-7	2.0	S:80+N:20	0.5	0.3	0.05	87	2500	86
実施例4-8	2.0	S:80+N:20	0.5	0.3	0.5	06	2500	. 86
実施例4-9*4	2.0	S:80+N:20	0.5	0.3	0.5	06	2500	86
	书							
	ジェ電子分	抵 光						
※3 份配	被膜で被覆	する前の値						
[2	と世十十二	1	4					

図8に示す構造の負極を作製した **※** 4 表4-1及び表4-2に示す結果から明らかなように、各実施例と もに最大放電容量が高く、また容量維持率も高いことが判る。

産業上の利用可能性

本発明の非水電解液二次電池用負極では、活物質が電極の表面に露 出しておらず電極の内部に包埋されているので、活物質の脱落が防止され、また充放電を繰り返しても活物質の集電性が確保される。また、電気的に孤立した活物質が存在することが効果的に防止され、十分な集電性を得ることができる。この負極を用いた二次電池は、充放電の初期段階から充放電容量が高い。また、充放電を繰り返しても劣化 10 率が低くサイクル寿命が大幅に長くなり、充放電効率も高くなる。その上、心材としての導電性金属箔層、つまり従来の負極に用いられていた集電体を用いないので、従来の負極よりも負極全体に占める活物質の割合を高くすることができる。その結果、単位体積当たり及び単位重量当たりのエネルギー密度の高い二次電池用負極を得ることがで きる。

5

62

請 求 の 範 囲

- 1. 表面が電解液と接する一対の集電用表面層と、該表面層間に介在されたリチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子を含む少なくとも一層の活物質層とを備えていることを特徴とする非水電解液二次電池用負極。
- 2. 前記面を構成する材料が前記活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して両面が電気的に導通しており、電極全体が一体として集電機能を有している請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 3. 前記表面層はその厚みが 0. 3~10 μ m である請求の範囲第1項 10 記載の非水電解液二次電池用負極。
 - 4. 前記表面層がリチウム化合物の形成能の低い金属材料からなる請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
 - 5. 前記表面層が、銅、ニッケル、鉄、コバルト又はこれらの金属の合金からなる請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 15 6. 前記表面層が、電解めっきによって形成されている請求の範囲第 1項記載の非水電解液二次電池用負極。
 - 7. 前記表面層に、該表面層の厚さ方向へ延び且つ非水電解液の浸透が可能な微細空隙が多数形成されている請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 20 8. 前記微細空隙が前記活物質層と通じ、少なくとも一方の前記表面層における前記微細空隙の平均開孔面積が 0. 1~50 μ m ²で且つ開孔率が 0. 1~20%であり、集電用の厚膜導電体を有していないこ

とを特徴とする請求の範囲第7項記載の非水電解液二次電池用負極。

- 9. 前記活物質の粒子がシリコン系材料又はスズ系材料の粒子からなる請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 10. 前記活物質粒子が、シリコン又はスズ単体の粒子である請求の 5 範囲第9項記載の非水電解液二次電池用負極。
 - 11. 前記活物質粒子が、少なくともシリコン又はスズと炭素との混合粒子であり、該混合粒子が、10~90重量%のシリコン又はスズ及び90~10重量%の炭素を含む請求の範囲第9項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 10 1 2. 前記活物質粒子が、シリコン又はスズと金属との混合粒子であり、該混合粒子が、30~99.9重量%のシリコン又はスズ並びに0.1~70重量%のCu、Ag、Li、Ni、Co、Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn(但し、前記粒子がスズを含む場合を除く)、Si(但し、前記粒子がシリコンを含む場合を除く)、In、
 15 V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される1種類以上の元素を含む請求の範囲第9項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 13.前記活物質粒子が、シリコン化合物又はスズ化合物の粒子であり、該シリコン化合物又はスズ化合物の粒子が、30~99.9重量%
 20 のシリコン又はスズ並びに0.1~70重量%のCu、Ag、Li、Ni、Co、Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn(但し、前記粒子がスズを含む場合を除く)、Si(但し、前記粒子がシリコンを含む場合を除く)、In、V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される1種類以上

の元素を含む請求の範囲第9項記載の非水電解液二次電池用負極。

14. 前記活物質粒子が、シリコン化合物又はスズ化合物の粒子と金属粒子との混合粒子であり、

前記混合粒子は、30~99.9重量%のシリコン化合物又はスズ 1 化合物の粒子並びに0.1~70重量%のCu、Ag、Li、Ni、Co、Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn(但し、前記化合物の粒子がスズを含む場合を除く)、Si(但し、前記化合物の粒子がシリコンを含む場合を除く)、In、V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される 1 種類以上の元素の粒子を含み、

前記化合物の粒子は、30~99.9重量%のシリコン又はスズ並びに0.1~7.0重量%のCu、Ag、Li、Ni、Co、Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn(但し、前記化合物の粒子がスズを含む場合を除く)、Si(但し、前記化合物の粒子がシリコンを含む場合を除く)、Si(但し、前記化合物の粒子がシリコンを含む15 場合を除く)、In、V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される1種類以上の元素を含む請求の範囲第9項記載の非水電解液二次電池用負極。

15. 前記活物質粒子が、シリコン単体又はスズ単体の粒子の表面に 金属が被覆されてなる粒子であり、該金属がCu、Ag、Ni、Co、20 Fe、Cr、Zn、B、Al、Ge、Sn(但し、前記粒子がスズを 含む場合を除く)、Si(但し、前記粒子がシリコンを含む場合を除く)、In、V、Ti、Y、Zr、Nb、Ta、W、La、Ce、Pr、Pd及びNdからなる群から選択される1種類以上の元素であり、 該粒子が30~99.9重量%のシリコン又はスズ及び0.1~70 重量%の該金属を含む請求の範囲第9項記載の非水電解液二次電池用

負極。

16. 前記活物質粒子がシリコンを含み、平均粒径 (D₅₀) が 0. 1~ 10 μmであり、

前記活物質粒子は、酸素の濃度が2.5重量%未満で且つ最表面に おけるシリコンの濃度が酸素の濃度の1/2超である請求の範囲第1 項記載の非水電解液二次電池用負極。

- 17. 前記活物質粒子は、その最大径が 50 μm以下である請求の範囲 第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 18.前記活物質層が、前記活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗 10 布して形成されている請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用 負極。
 - 19. 厚さ方向の中央部に、心材としての導電性金属箔層を備えておらず、全体の厚みが2~50 μmである請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 15 2 0 . 厚さ方向の中央部に、心材としての導電性金属箔層を備え、該金属箔層の各面に前記活物質層がそれぞれ形成されており、更に各活物質層を被覆する前記集電用表面層がそれぞれ形成されており、全体の厚みが 1 0~1 0 0 μ m である請求の範囲第 1 項記載の非水電解液二次電池用負極。
- 20 21.請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極の製造方法であって、

キャリア箔上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物 質層を形成し、 該活物質層が形成された該キャリア箔を、金属材料を含むめっき浴 中に浸漬して電解めっきを行い、該活物質層を含む電極を形成し、

然る後、該電極を該キャリア箔から剥離分離することを特徴とする 非水電解液二次電池用負極の製造方法。

- 5 22.前記キャリア箔上に前記活物質層を形成するに先立ち、該キャリア箔上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方の集電用表面層を形成し、該集電用表面層の上に前記活物質層を形成し、該活物質層の上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の集電用表面層を形成し、然る後、前記キャリア10 箔を前記一方の集電用表面層から剥離分離する請求の範囲第21項記載の非水電解液二次電池用負極の製造方法。
 - 23. 前記一方の集電用表面層を形成するに先立ち、該集電用表面層の構成材料と異質の材料からなる被覆体を、前記キャリア箔上に 0.00~1 μmの厚さで形成し、
- 15 その上に前記集電用表面層の構成材料を電解めっきによって電析させて該集電用表面層を形成する請求の範囲第22項記載の非水電解液 二次電池用負極の製造方法。
 - 24. 請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極の製造方法であって、
- 20 表面に多数の陽イオン交換基を有するキャリア樹脂を金属イオン含有液で処理して該陽イオン交換基の金属塩を生成させ、該金属塩を還元してキャリア樹脂の前記表面に触媒核となる前記金属の被膜を形成し、該被膜上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方の集電用表面層を形成し、該集電用表面層の上に活物質の粒25 子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、該活物質層の上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の

集電用表面層を形成し、然る後、前記キャリア樹脂を剥離又は溶解により前記一方の集電用表面層から分離することを特徴とする非水電解液二次電池用負極の製造方法。

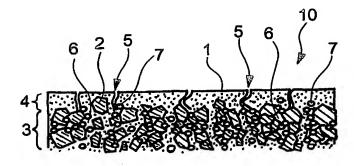
25. 請求の範囲20記載の非水電解液二次電池用負極の製造方法で 5 あって、

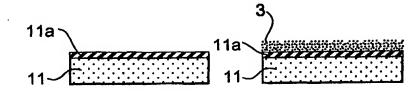
導電性金属箔の各面に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層をそれぞれ形成し、

該活物質層が形成された該導電性金属箔を、リチウム化合物の形成 能の低い金属材料を含むめっき浴中に浸漬して電解めっきを行うこと 10 を特徴とする非水電解液二次電池用負極の製造方法。

26.請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池用負極を備えた非水電解液二次電池。

Fig.1





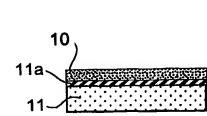
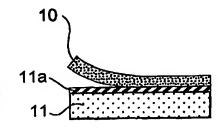
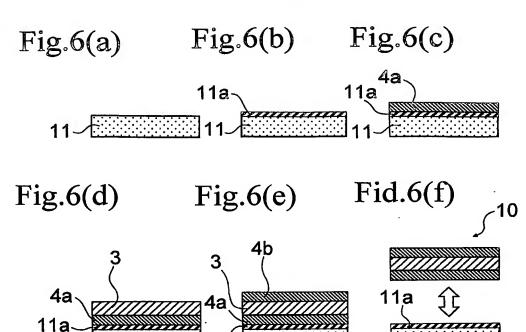
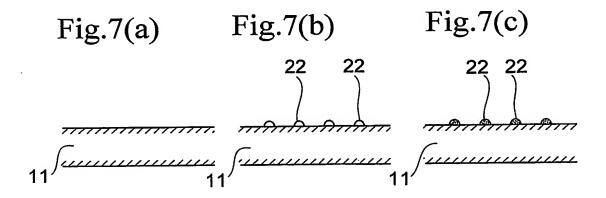


Fig.4(d)







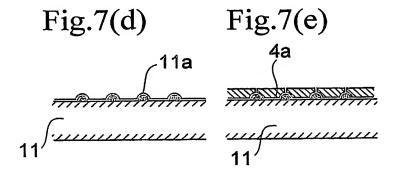


Fig.8

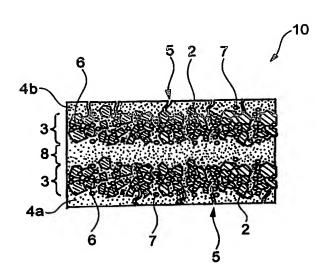


Fig.11(a)

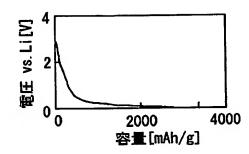


Fig.11(b)

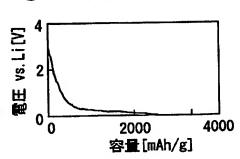


Fig.12

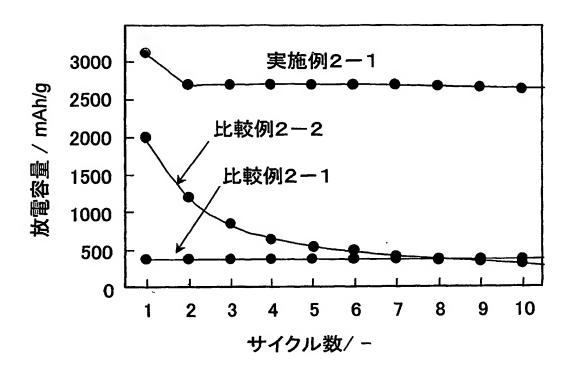


Fig.2

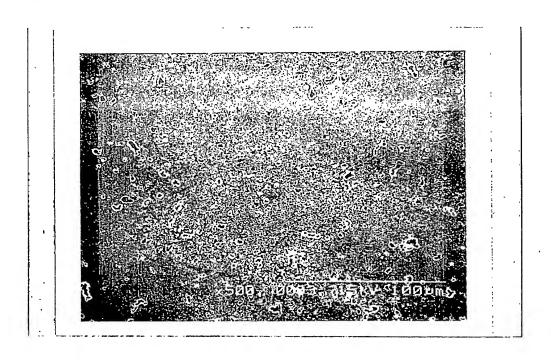


Fig.3

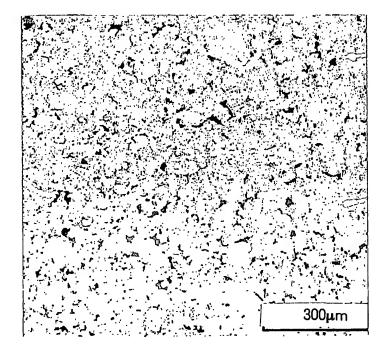


Fig.5(a)

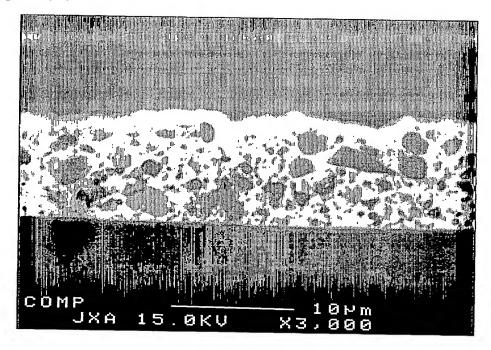


Fig.5(b)

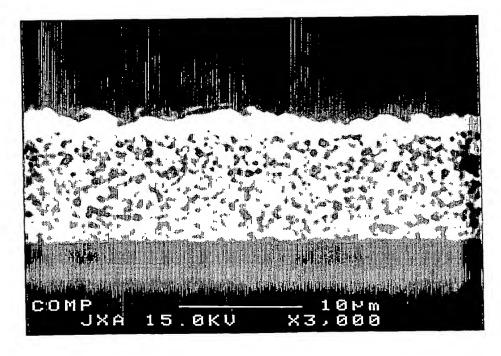


Fig.9

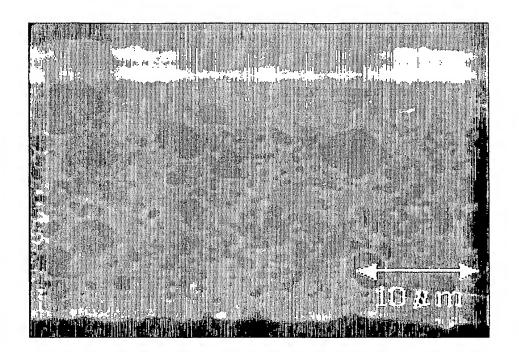


Fig.10(a)

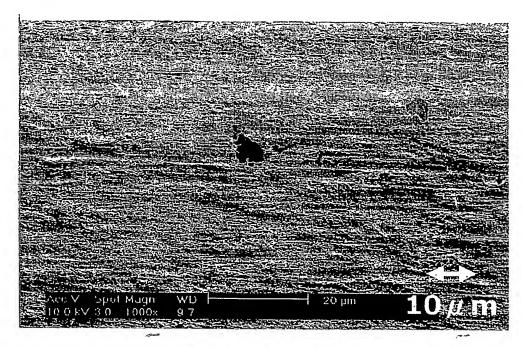
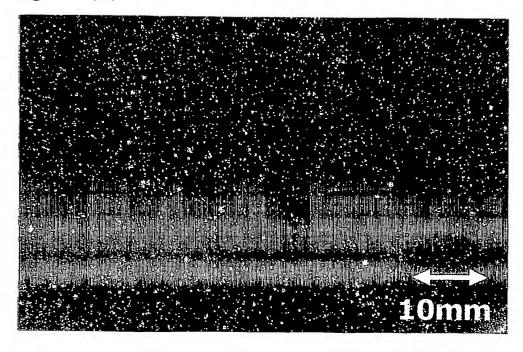


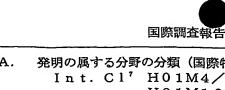
Fig.10(b)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 H01M4/02, H01M4/38, H01M4/	04, H01M10/40, H01M4/64	4
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed to C1 H01M4/00-4/04, H01M4/36-4/	by classification symbols) 62, H01M10/40	
Jits	ion searched other than minimum documentation to the Lyo Shinan Koho 1922—1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004	extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	o 1994–2004
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·	
Category*	Citation of document, with indication, where ap	• •	Relevant to claim No.
· X	JP 08-050922 A (Canon Inc.), 20 February, 1996 (20.02.96), Full text		1,2,4-6, 9-15,18-20, 26
Y	& EP 690517 A1 & US	6051340 A	1-26
Y	JP 2002-289178 A (Sanyo Elec 04 October, 2002 (04.10.02), Full text & US 2002/168572 A	tric Co., Ltd.),	1 <u>-</u> 26
Y	WO 02/21616 A1 (Sanyo Electr 14 March, 2002 (14.03.02), Full text & AU 8256901 A & EP	ic Co., Ltd.),	1-26
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum than th	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is aken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to i		
13 A	actual completion of the international search spril, 2004 (13.04.04)	Date of mailing of the international sear 27 April, 2004 (27	
Name and n	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N		Telephone No.	

[-
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 08-171901 A (Canon Inc.), 02 July, 1996 (02.07.96), Claim 1 & EP 709907 A1 & US 5698339 A	7,8
Y	JP 11-135120 A (Kao Corp.), 21 May, 1999 (21.05.99), Claims 1 to 7 (Family: none)	11-15,17
Y	JP 08-250113 A (Honjo Kinzoku Kabushiki Kaisha), 27 September, 1996 (27.09.96), Claim 1 (Family: none)	21-25
Y	JP 08-124579 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 17 May, 1996 (17.05.96), Claims 1 to 4 (Family: none)	21-25
Y	JP 2001-073159 A (Nippon Rironaru Kabushiki Kaisha), 21 March, 2001 (21.03.01), Claims 1, 2 (Family: none)	24
A	WO 01/039303 Al (Moltech Corp.), 31 May, 2001 (31.05.01), & JP 2003-515892 A & EP 1234348 Al & EP 1236231 Al & US 2002/12846 Al	1-26
A	JP 2002-015729 A (Toshiba Corp.), 18 January, 2002 (18.01.02), (Family: none)	1-26 .
A	JP 2002-042783 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 08 February, 2002 (08.02.02), & US 2002/34687 A1	1-26
A	JP 08-213008 A (Canon Inc.), 20 August, 1996 (20.08.96), & EP 715366 A1 & US 6063142 A	1-26
A	JP 08-037000 A (Mitsubishi Cable Industries, Ltd.), 06 February, 1996 (06.02.96), (Family: none)	1-26
		1



Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01M4/02, H01M4/38, H01M4/04, H01M10/40, H01M4/64

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01M4/00-4/04, H01M4/36-4/62H01M10/40

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

	5と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 08-050922 A (キャノン株式会社), 1996. 0 2. 20, 全文 & EP 690517 A1 & US 605	1, 2, 4-6, 9-1 5, 18-20, 26
Y	1340 A	,
1	1340 A	1 - 26
Y	JP 2002-289178 A (三洋電機株式会社), 200	1 - 26
	2. 10. 04, 全文 & US 2002/168572 A	
Y	WO 02/21616 A1 (三洋電機株式会社), 2002. 0	1-2.6
	3. 14, 全文 & AU 8256901 A & EP 133	. — -

区欄の続きにも文献が列挙されている。

5438 A1

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

27. 4. 2004 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 13.04.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9151 4 X 日本国特許庁(ISA/JP) 天野 斉 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3477

		20100
C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 08-171901 A (キャノン株式会社), 1996. 07. 02, 請求項1 & EP 709907 A1 & US 5698339 A	7, 8
Y	JP 11-135120 A (花王株式会社), 1999. 05. 21, 請求項1-7 (ファミリーなし)	11–15, 17
Y	JP 08-250113 A (本城金属株式会社), 1996. 0 9. 27, 請求項1 (ファミリーなし)	21-25
Y	JP 08-124579 A (住友電気工業株式会社), 199 6.05.17,請求項1-4 (ファミリーなし)	21-25
Y _.	JP 2001-073159 A (日本リーロナール株式会社), 2001.03.21,請求項1,2 (ファミリーなし)	2 4
A	WO 01/039303 A1 (モルテック・コーポレーション) , 2001. 05. 31 & JP 2003-515892 A & EP 1234348 A1 & EP 1236231 A1 & US 2002/12846 A1	1-26
A	JP 2002-015729 A (株式会社東芝), 2002. 0 1. 18 (ファミリーなし)	1-26
A	JP 2002-042783 A (三洋電機株式会社), 200 2.02.08 & US 2002/34687 A1	1-26
A	JP 08-213008 A (キャノン株式会社), 1996. 0 8. 20 & EP 715366 A1 & US 606314 2 A	1-26
A	JP 08-037000 A (三菱電線工業株式会社), 199 6.02.06 (ファミリーなし)	1-26
	1	Į.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.